



#3  
111  
10-03-02

**PATENT APPLICATION**

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re application of

Docket No: Q69083

Toshiaki AOAI, et al.

Appln. No.: 10/099,981

Group Art Unit: 1752

Confirmation No.: 5513

Examiner: Not Yet Assigned

Filed: March 19, 2002

For: POSITIVE RESIST COMPOSITION

**SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT**

Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

**RECEIVED**

OCT - 2 2002

**TC 1700**

Sir:

Submitted herewith is a certified copy of the priority document on which a claim to priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to acknowledge receipt of said priority document.

Respectfully submitted,

SUGHRUE MION, PLLC  
2100 Pennsylvania Avenue, N.W.  
Washington, D.C. 20037-3213  
Telephone: (202) 293-7060  
Facsimile: (202) 293-7860

*for John Callahan Reg. No. 32,607*  
Mark Boland  
Registration No. 32,197

Enclosures: JAPAN 2001-079184

Date:



日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

Inventor Name: Toshiaki AOAI, et al.  
U.S. Appl. No: 10/099,981  
Group Art No: 1752

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2001年 3月19日

出 願 番 号  
Application Number:

特願2001-079184

[ ST.10/C ]:

[ JP2001-079184 ]

出 願 人  
Applicant(s):

富士写真フイルム株式会社

RECEIVED

OCT - 2 2002

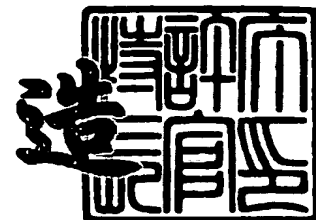
TC 1700



2002年 5月10日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2002-3033714

【書類名】 特許願  
【整理番号】 P-37314  
【提出日】 平成13年 3月19日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 G03F 7/039  
【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻4 0 0 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 青合 利明

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻4 0 0 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 水谷 一良

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻4 0 0 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 漢那 慎一

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100105647

【弁理士】

【氏名又は名称】 小栗 昌平

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100105474

【弁理士】

【氏名又は名称】 本多 弘徳

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100108589

【弁理士】

【氏名又は名称】 市川 利光

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100115107

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 猛

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100090343

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗宇 百合子

【電話番号】 03-5561-3990

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 092740

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0003489

【プルーフの要否】 要

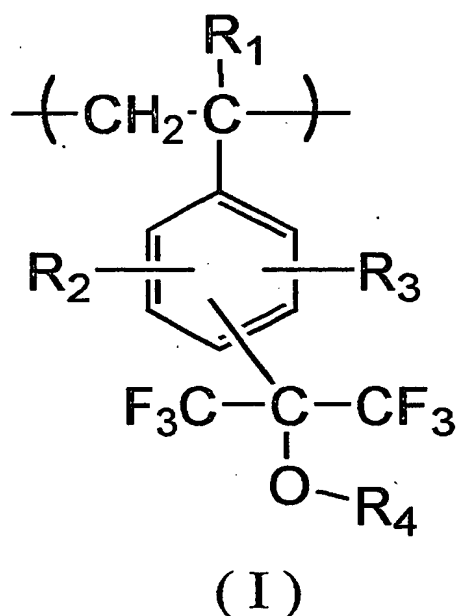
【書類名】 明細書

【発明の名称】 ポジ型レジスト組成物

【特許請求の範囲】

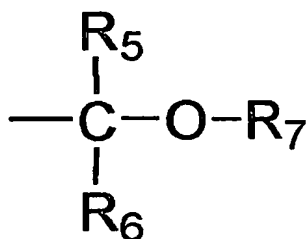
【請求項1】 (A) 下記一般式 (I) で示される繰り返し単位を少なくとも一つ有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解度を増大する樹脂、及び (B) 活性光線又は放射線の照射により、酸を発生する化合物を含有するポジ型レジスト組成物。

【化1】



式中、 $\text{R}_1$ は水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、置換基を有していても良い、アルキル基又はハロアルキル基を表す。 $\text{R}_2$ 、 $\text{R}_3$ は同じでも異なっても良く、水素原子、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、シアノ基、アルコキシ基、アシル基又は置換基を有していても良いアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アラルキル基もしくはアリール基を表す。 $\text{R}_4$ は水素原子、置換基を有していても良い、アルキル基、パーフルオロアルキル基、シクロアルキル基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アルコキシカルボニルメチル基、又は式 (II) の基を表す。

【化 2】

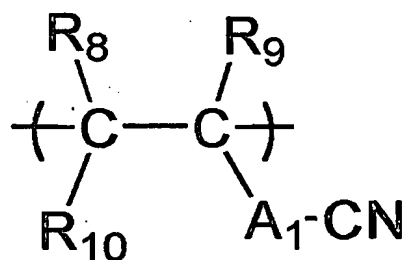


( II )

R<sub>5</sub>、R<sub>6</sub>は同じでも異なっても良く、水素原子、置換基を有していても良いアルキル基もしくはシクロアルキル基を表す。R<sub>7</sub>は置換基を有していても良いアルキル基、パーフルオロアルキル基、シクロアルキル基、パーフルオロシクロアルキル基、アラルキル基もしくはアリール基を表す。またR<sub>5</sub>～R<sub>7</sub>の2つが結合し、環を形成しても良い。

【請求項 2】 (A) の樹脂が、更に下記一般式 ( I I I ) で示される繰り返し単位を少なくとも一つ有することを特徴とする請求項 1 に記載のポジ型レジスト組成物。

【化 3】



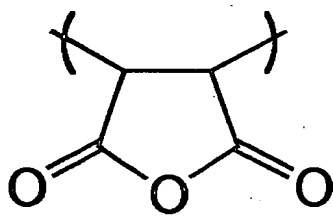
( III )

式中、R<sub>8</sub>、R<sub>9</sub>は同じでも異なっても良く、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、置換基を有していても良い、アルキル基又はハロアルキル基を表す。R<sub>10</sub>は、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有していても良い、アルキル基又はハロアルキル基、もしくは-A<sub>1</sub>-CN基を表す。A<sub>1</sub>は単結合、置換基を有しても良い、2価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基もしくはアリレン基、又は-O-CO-R<sub>11</sub>、-CO-O-R<sub>12</sub>、-CO-N(R<sub>13</sub>)-R<sub>14</sub>を表す。R<sub>11</sub>、R<sub>12</sub>、R<sub>14</sub>は同じでも異なっても良く、単結合、

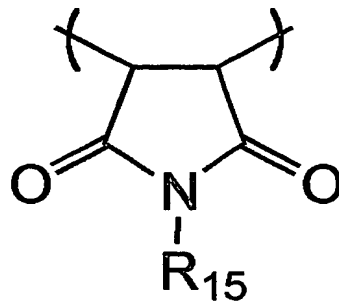
又はエーテル基、エステル基、アミド基、ウレタン基もしくはウレイド基を有しても良い、2 価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基又はアリーレン基を表す。R<sub>13</sub>は水素原子、置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基又はアリール基を表す。

【請求項 3】 (A) の樹脂が、更に一般式 (I V)、(V) で示される繰り返し単位のうち少なくとも一つ有することを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載のポジ型レジスト組成物。

【化 4】



(IV)

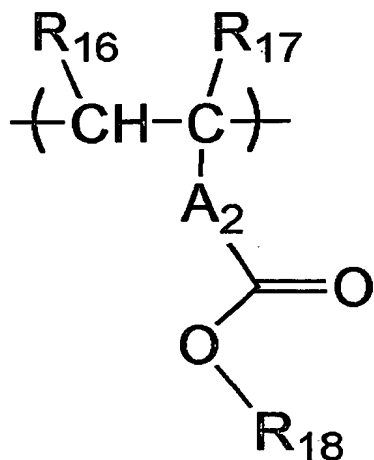


(V)

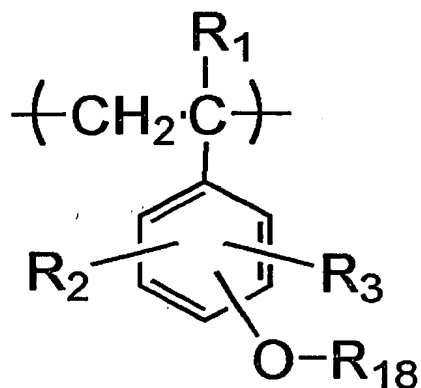
式中、R<sub>15</sub>は水素原子、置換基を有していても良い、アルキル基、パーフルオロアルキル基、シクロアルキル基、パーフルオロシクロアルキル基、もしくはアリール基を表す。

【請求項 4】 (A) の樹脂が、更に一般式 (V I) 及び (V I I) で示される繰り返し単位のうち少なくとも一つ有することを特徴とする請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【化5】



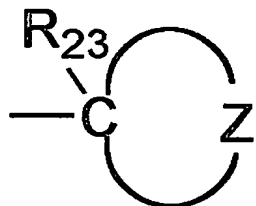
(VI)



(VII)

式中、 $\text{R}_{16}$ 、 $\text{R}_{17}$ は、同じでも異なっても良く、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、置換基を有していても良い、アルキル基又はハロアルキル基を表す。 $\text{R}_{18}$ は $-\text{C}(\text{R}_{19})(\text{R}_{20})(\text{R}_{21})$ 、 $-\text{C}(\text{R}_{19})(\text{R}_{20})(\text{OR}_{22})$ 、もしくは式(VIII)で示される基を表す。 $\text{R}_{19} \sim \text{R}_{22}$ は同じでも異なっても良く、置換基を有していても良い、アルキル基、単環又は多環のシクロアルキル基、アルケニル基、アラルキル基もしくはアリール基を表す。 $\text{R}_{19}$ 、 $\text{R}_{20}$ 、 $\text{R}_{21}$ の内の2つ、又は $\text{R}_{19}$ 、 $\text{R}_{20}$ 、 $\text{R}_{22}$ の内の2つが結合して環を形成しても良い。式(VIII)中 $\text{R}_{23}$ は置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アラルキル基もしくはアリール基を表す。 $\text{Z}$ は炭素原子と共に単環又は多環の脂環式基を構成する原子団を表す。

【化6】



(VIII)

【請求項5】 更に(C) 酸拡散抑制剤として、塩基性窒素原子を有する化合



物を含むことを特徴とする請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項 6】 (B) 成分の化合物が、活性光線又は放射線の照射により、炭素原子数 2 以上のパーフルオロアルキルスルホン酸、パーフルオロアリースルホン酸もしくはパーフルオロアルキル基が置換したアルールスルホン酸を発生するスルホニウム塩又はヨードニウム塩の化合物から選択されることを特徴とする請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項 7】 (B) 成分の化合物が、イミド-N-スルホネート化合物、オキシム-N-スルホネート化合物、もしくはジスルホン化合物から選択されることを特徴とする請求項 1 ～ 6 のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項 8】 露光光源として、160nm以下の真空紫外光を使用することを特徴とする請求項 1 ～ 7 のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、超 L S I、高容量マイクロチップの製造などのマイクロリソグラフィプロセスや、その他のフォトファブリケーションプロセスに好適に用いられるポジ型レジスト組成物に関するものである。更に詳しくは、160nm以下の真空紫外光を使用して高精細化したパターンを形成し得るポジ型レジスト組成物に関するものである。

##### 【0002】

#### 【従来の技術】

集積回路はその集積度を益々高めており、超 L S I などの半導体基板の製造においては、クォーターミクロン以下の線幅から成る超微細パターンの加工が必要とされるようになってきた。パターンの微細化を図る手段の一つとして、レジストのパターン形成の際に使用される露光光源の短波長化が知られている。このことは光学系の解像度（線幅）Rを表すレイリーの式、

$$R = k \cdot \lambda / NA$$

（ここで $\lambda$ は露光光源の波長、NAはレンズの開口数、kはプロセス定数）で説

明することができる。この式より高解像度を達成する、即ちRの値を小さくする為には、露光光源の波長 $\lambda$ を短くすれば良いことがわかる。

#### 【0003】

例えば64Mビットまでの集積度の半導体素子の製造には、現在まで高圧水銀灯のi線(365nm)が光源として使用されてきた。この光源に対応するポジ型レジストとしては、ノボラック樹脂と感光物としてのナフトキノンジアジド化合物を含む組成物が、数多く開発され、0.3 $\mu$ m程度までの線幅の加工においては十分な成果をおさめてきた。また256Mビット以上集積度の半導体素子の製造には、i線に代わりKrFエキシマレーザー光(248nm)が露光光源として採用されてきた。

更に1Gビット以上の集積度の半導体製造を目的として、近年より短波長の光源であるArFエキシマレーザー光(193nm)の使用、更には0.1 $\mu$ m以下のパターンを形成する為にF<sub>2</sub>エキシマレーザー光(157nm)の使用が検討されている。

#### 【0004】

これら光源の短波長化に合わせ、レジスト材料の構成成分及びその化合物構造も大きく変化している。即ち従来のノボラック樹脂とナフトキノンジアジド化合物を含むレジストでは、248nmの遠紫外領域における吸収が大きいため、光がレジスト底部まで十分に到達しにくくなり、低感度でテーパー形状のパターンしか得られなかった。

このような問題を解決する為、248nm領域での吸収の小さいポリ(ヒドロキシスチレン)を基本骨格とし酸分解基で保護した樹脂を主成分として用い、遠紫外光の照射で酸を発生する化合物(光酸発生剤)を組み合わせた組成物、所謂化学増幅型レジストが開発されるに至った。化学増幅型レジストは露光部に発生した酸の触媒分解反応により、現像液に対する溶解性を変化させる為、高感度で高解像度なパターンを形成することができる。

#### 【0005】

これらに有効な酸分解性樹脂及び光酸発生剤については、Polym. Eng. Sci., 23巻, 1012頁(1983)、ACS. Sym., 242巻, 11頁(1984)、

Macromolecules, 21巻, 1475頁(1988)、有機合成化学協会誌, 49巻, 437頁(1991)、「微細加工とレジスト」(共立出版、1987)など、多くの論文、特許などで報告されている。またArFエキシマレーザー光(193nm)を使用した場合、芳香族基を有する化合物が本質的に193nm波長領域に大きな吸収を有する為、上記化学増幅型レジストでも十分な性能は得られなかった。

## 【0006】

この問題に対し、ポリ(ヒドロキシスチレン)を基本骨格とする酸分解性樹脂を、193nmに吸収を持たない脂環式構造をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した酸分解性樹脂に代え、化学増幅型レジストの改良が図られている。

これら脂環型の酸分解性樹脂については、例えば特開平4-39665号、同7-234511号、同9-73173号、同7-199467号、同8-259626号、同9-221519号、同10-10739号、同9-230595号、同10-111569号、同10-218947号、同10-153864号、WO-97/33198号等の明細書に記載されている。

## 【0007】

更にF<sub>2</sub>エキシマレーザー光(157nm)に対しては、上記脂環型樹脂においても157nm領域の吸収が大きく、目的とする0.1μm以下のパターンを得るには不十分であることが判明した。これに対し、フッ素原子(パーフルオロ構造)を導入した樹脂が157nmに十分な透明性を有することがProc. SPIE. Vol.3678. 13頁(1999)にて報告され、有効なフッ素樹脂の構造がProc. SPIE. Vol.3999. 330頁(2000)、同357頁(2000)、同365頁(2000)、WO-00/17712号等に提案されるに至っている。

但しこれらフッ素樹脂を有するレジストは、耐ドライエッチング性は必ずしも十分とは言えず、またパーフルオロ構造に由来する特異な撥水、撥油特性の為、塗布性(塗布面の均一性)の改良、及び現像欠陥の抑制も望まれていた。

## 【0008】

## 【発明が解決しようとする課題】

従って、本発明の目的は、160nm以下、特にF<sub>2</sub>エキシマレーザー光(1

57 nm) の露光光源の使用に好適なポジ型レジスト組成物を提供することであり、具体的には157 nmの光源使用時に十分な透過性を示し、且つ塗布性、現像欠陥を満足するポジ型レジスト組成物を提供することである。

更に良好な感度、解像度でパターンを形成し、耐ドライエッチング性も優れるポジ型レジスト組成物を提供することである。

【0009】

【課題を解決するための手段】

本発明者等は、上記諸特性に留意し鋭意検討した結果、本発明の目的が以下の特定の組成物を使用することで見事に達成されることを見出し、本発明に到達した。

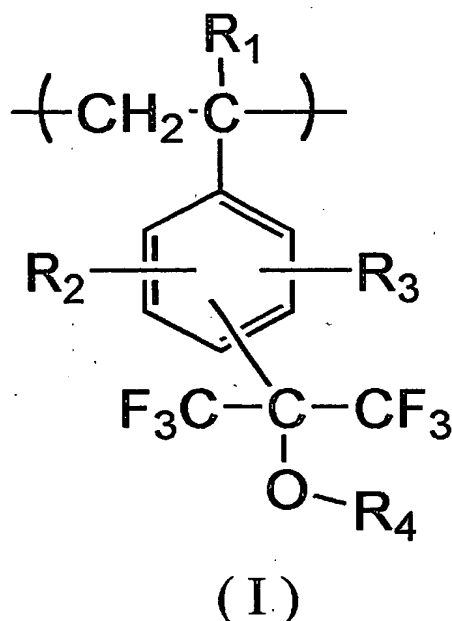
即ち、本発明は下記構成である。

【0010】

(1) (A) 下記一般式 (I) で示される繰り返し単位を少なくとも一つ有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解度を増大する樹脂、及び (B) 活性光線又は放射線の照射により、酸を発生する化合物を含有するポジ型レジスト組成物。

【0011】

【化7】

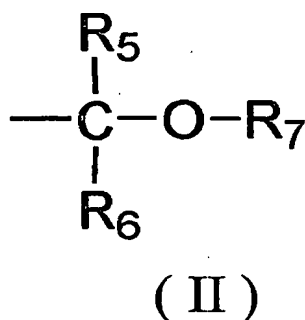


## 【0012】

式中、 $R_1$ は水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、置換基を有していても良い、アルキル基又はハロアルキル基を表す。 $R_2$ 、 $R_3$ は同じでも異なっても良く、水素原子、ヒドロキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、アルコキシ基、アシル基又は置換基を有していても良いアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アラルキル基もしくはアリール基を表す。 $R_4$ は水素原子、置換基を有していても良い、アルキル基、パーフルオロアルキル基、シクロアルキル基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アルコキシカルボニルメチル基、又は式(II)の基を表す。

## 【0013】

【化8】



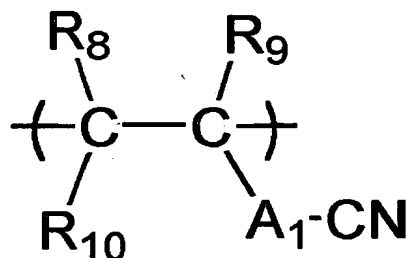
## 【0014】

$R_5$ 、 $R_6$ は同じでも異なっても良く、水素原子、置換基を有していても良いアルキル基もしくはシクロアルキル基を表す。 $R_7$ は置換基を有していても良いアルキル基、パーフルオロアルキル基、シクロアルキル基、パーフルオロシクロアルキル基、アラルキル基もしくはアリール基を表す。また $R_5 \sim R_7$ の2つが結合し、環を形成しても良い。

(2) (A)の樹脂が、更に下記一般式(III)で示される繰り返し単位を少なくとも一つ有することを特徴とする前記(1)に記載のポジ型レジスト組成物。

## 【0015】

【化9】



(III)

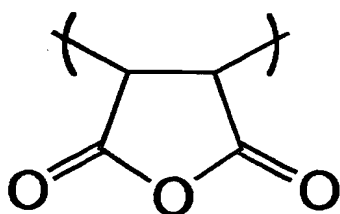
【0016】

式中、 $\text{R}_8$ 、 $\text{R}_9$ は同じでも異なっても良く、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、置換基を有していても良い、アルキル基又はハロアルキル基を表す。 $\text{R}_{10}$ は、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有していても良い、アルキル基又はハロアルキル基、もしくは $-\text{A}_1\text{-CN}$ 基を表す。 $\text{A}_1$ は単結合、置換基を有しても良い、2価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基もしくはアリーレン基、又は $-\text{O}-\text{CO}-\text{R}_{11}-$ 、 $-\text{CO}-\text{O}-\text{R}_{12}-$ 、 $-\text{CO}-\text{N}(\text{R}_{13})-\text{R}_{14}-$ を表す。 $\text{R}_{11}$ 、 $\text{R}_{12}$ 、 $\text{R}_{14}$ は同じでも異なっても良く、単結合、又はエーテル基、エステル基、アミド基、ウレタン基もしくはウレイド基を有しても良い、2価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基又はアリーレン基を表す。 $\text{R}_{13}$ は水素原子、置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基又はアリアル基を表す。

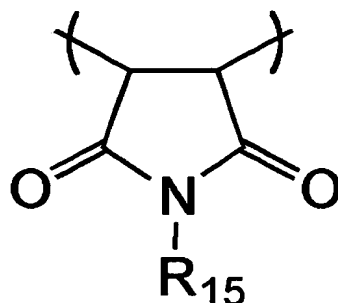
(3) (A) の樹脂が、更に下記一般式 (IV)、(V) で示される繰り返し単位のうち少なくとも一つ有することを特徴とする前記 (1) 又は (2) に記載のポジ型レジスト組成物。

【0017】

【化10】



(IV)



(V)

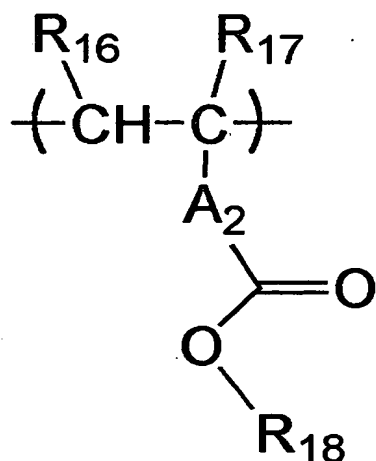
【0018】

式中、 $R_{15}$ は水素原子、置換基を有していても良い、アルキル基、パーフルオロアルキル基、シクロアルキル基、パーフルオロシクロアルキル基、もしくはアリアル基を表す。

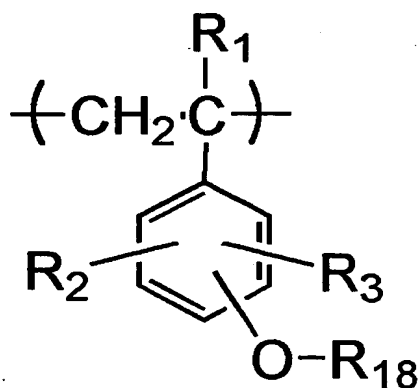
(4) (A) の樹脂が、更に一般式 (VI) 及び (VII) で示される繰り返し単位のうち少なくとも一つ有することを特徴とする前記 (1) ~ (3) のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【0019】

【化11】



(VI)



(VII)

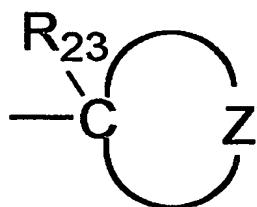
【0020】

式中、 $R_{16}$ 、 $R_{17}$ は、同じでも異なっても良く、水素原子、ハロゲン原子

、シアノ基、置換基を有していても良い、アルキル基又はハロアルキル基を表す。 $R_{18}$ は $-C(R_{19})(R_{20})(R_{21})$ 、 $-C(R_{19})(R_{20})(OR_{22})$ 、もしくは式(VIII)で示される基を表す。 $R_{19} \sim R_{22}$ は同じでも異なっても良く、置換基を有していても良い、アルキル基、単環又は多環のシクロアルキル基、アルケニル基、アラルキル基もしくはアリール基を表す。 $R_{19}$ 、 $R_{20}$ 、 $R_{21}$ の内の2つ、又は $R_{19}$ 、 $R_{20}$ 、 $R_{22}$ の内の2つが結合して環を形成しても良い。式(VIII)中、 $R_{23}$ は置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アラルキル基もしくはアリール基を表す。 $Z$ は炭素原子と共に単環又は多環の脂環式基を構成する原子団を表す。

【0021】

【化12】



(VIII)

【0022】

(5) 更に(C)酸拡散抑制剤として、塩基性窒素原子を有する化合物を含有することを特徴とする前記(1)～(4)のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

(6) (B)成分の化合物が、活性光線又は放射線の照射により、炭素原子数2以上のパーフルオロアルキルスルホン酸、パーフルオロアリールスルホン酸、もしくはパーフルオロアルキル基が置換したアルールスルホン酸を発生するスルホニウム塩又はヨードニウム塩の化合物から選択されることを特徴とする前記(1)～(5)のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

(7) (B)成分の化合物が、イミド-N-スルホネート化合物、オキシム-N-スルホネート化合物、もしくはジスルホン化合物から選択されることを特徴とする前記(1)～(6)のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。



(8) 露光光源として、160nm以下の真空紫外光を使用することを特徴とする前記(1)～(7)のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

### 【0023】

#### 【発明の実施の形態】

以下、本発明に使用する化合物について詳細に説明する。

#### [1] 本発明(A)の樹脂

本発明(A)における樹脂は、一般式(I)で表されるヘキサフルオロ-2-プロパノール基、又はヘキサフルオロ-2-プロパノール基のOH基を酸分解性基で保護した基で置換したスチレン誘導体の繰り返し単位を少なくとも一つ有する樹脂である。好ましくは更に、一般式(III)で表される繰り返し単位の少なくとも一つを有する酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解度を増大する樹脂である。また必要に応じ、本発明(A)の樹脂の親疎水性、ガラス転移点、露光光に対する透過性等の物性を制御する為、あるいはポリマー合成時の重合性を制御する為に、一般式(IV)～(VII)で表される繰り返し単位を少なくとも一つ有しても良い。

### 【0024】

一般式中、 $R_1$ は水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、置換基を有していても良い、アルキル基又はハロアルキル基を表す。 $R_2$ 、 $R_3$ は同じでも異なっても良く、水素原子、ヒドロキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、アルコキシ基、アシル基又は置換基を有していても良いアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アラルキル基もしくはアリール基を表す。

$R_4$ は水素原子、置換基を有していても良い、アルキル基、パーフルオロアルキル基、単環又は多環のシクロアルキル基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アルコキシカルボニルメチル基、又は前記一般式(II)の基を表す。

### 【0025】

$R_5$ 、 $R_6$ は同じでも異なっても良く、水素原子、置換基を有していても良いアルキル基、もしくはシクロアルキル基を表す。 $R_7$ は置換基を有していても良いアルキル基、パーフルオロアルキル基、シクロアルキル基、パーフルオロシクロアルキル基、アラルキル基もしくはアリール基を表す。また $R_5 \sim R_7$ の2つ

が結合し、環を形成しても良い。

$R_8$ 、 $R_9$ は同じでも異なっても良く、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、置換基を有していても良い、アルキル基又はハロアルキル基を表す。 $R_{10}$ は、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有していても良い、アルキル基又はハロアルキル基、もしくは $-A_1-CN$ 基を表す。

$A_1$ は単結合、置換基を有していても良い、2価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基もしくはアリーレン基、又は $-O-CO-R_{11}-$ 、 $-CO-O-R_{12}-$ 、 $-CO-N(R_{13})-R_{14}-$ を表す。

#### 【 0 0 2 6 】

$R_{11}$ 、 $R_{12}$ 、 $R_{14}$ は同じでも異なっても良く、単結合、又はエーテル基、エステル基、アミド基、ウレタン基もしくはウレイド基を有していても良い、2価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基又はアリーレン基を表す。 $R_{13}$ は水素原子、置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基又はアリール基を表す。 $R_{15}$ は水素原子、置換基を有していても良い、アルキル基、パーフルオロアルキル基、シクロアルキル基、パーフルオロシクロアルキル基、もしくはアリール基を表す。

$R_{16}$ 、 $R_{17}$ 同じでも異なっても良く、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、置換基を有していても良い、アルキル基又はハロアルキル基を表す。 $R_{18}$ は $-C(R_{19})(R_{20})(R_{21})$ 、 $-C(R_{19})(R_{20})(OR_{22})$ 、もしくは前記一般式(VIII)の基を表す。 $R_{19} \sim R_{22}$ は同じでも異なっても良く、置換基を有していても良い、アルキル基、単環又は多環のシクロアルキル基、アルケニル基、アラルキル基もしくはアリール基を表す。

#### 【 0 0 2 7 】

$R_{19}$ 、 $R_{20}$ 、 $R_{21}$ の内の2つ、又は $R_{19}$ 、 $R_{20}$ 、 $R_{22}$ の内の2つが結合して環を形成しても良い。 $R_{23}$ は置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アラルキル基もしくはアリール基を表す。 $Z$ は炭素原子と共に単環又は多環の脂環式基を構成する原子団を表す。

#### 【 0 0 2 8 】

また、上記アルキル基としては、例えば炭素数1～8個のアルキル基であって

、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、*n*-ブチル基、*sec*-ブチル基、ヘキシル基、2-エチルヘキシル基、オクチル基を好ましく挙げることができる。シクロアルキル基としては単環型でも良く、多環型でも良い。単環型としては炭素数3～8個のものであって、例えばシクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘブチル基、シクロオクチル基を好ましく挙げることができる。多環型としては炭素数6～20個のものであって、例えばアダマンチル基、ノルボルニル基、イソボロニル基、カンファニル基、ジシクロペンチル基、 $\alpha$ -ピネル基、トリシクロデカニル基、テトラシクロドデシル基、アンドロスタニル基等を好ましく挙げることができる。

## 【0029】

パーフルオロアルキル基としては、例えば炭素数1～12個のものであって、具体的にはトリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、2, 2, 2-トリフルオロエチル基、ヘプタフルオロプロピル基、2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロ-1-プロピル基、2, 2, 3, 4, 4, 4-ヘキサフルオロ-1-ブチル基、2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロ-1-ブチル基、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロ-1-ペンチル基、パーフルオロブチル基、パーフルオロヘキシル基、パーフルオロヘキシルエチル基、パーフルオロヘブチルメチル基、パーフルオロオクチル基、パーフルオロオクチルエチル基、パーフルオロデシルエチル基等を好ましくあげることができる。

## 【0030】

パーフルオロシクロアルキル基としては、フッ素基が複数置換した単環型、又は多環型のシクロアルキル基である。単環型としては炭素数3～8個のものであって、例えばパーフルオロシクロプロピル基、パーフルオロシクロペンチル基、パーフルオロシクロヘキシル基を好ましく挙げることができる。多環型としては炭素数6～20個のものであって、例えばパーフルオロアダマンチル基、パーフルオロノルボルニル基、パーフルオロイソボロニル基、パーフルオロトリシクロデカニル基、パーフルオロテトラシクロドデシル基等を好ましく挙げることができる。ハロアルキル基としては、例えば炭素数1～4個のハロアルキル基であって、具体的にはクロロメチル基、クロロエチル基、クロロプロピル基、クロロブ

チル基、プロモメチル基、プロモエチル基等を好ましく挙げる事ができる。

#### 【0031】

アリール基としては、例えば炭素数6～15個のアリール基であって、具体的には、フェニル基、トリル基、ジメチルフェニル基、2, 4, 6-トリメチルフェニル基、ナフチル基、アントリル基、9, 10-ジメトキシアントリル基等を好ましく挙げる事ができる。アラルキル基としては、例えば炭素数7～12個のアラルキル基であって、具体的には、ベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基等を好ましく挙げる事ができる。

#### 【0032】

アルケニル基としては、例えば炭素数2～8個のアルケニル基であって、具体的には、ビニル基、アリル基、ブテニル基、シクロヘキセニル基を好ましく挙げる事ができる。アルコキシ基としては、例えば炭素数1～8個のアルコキシ基であって、具体的には、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、iso-プロポキシ基、ブトキシ基、ペントキシ基、アリルオキシ基、オクトキシ基等を好ましく挙げる事ができる。

#### 【0033】

アシル基としては、例えば炭素数1～10個のアシル基であって、具体的には、ホルミル基、アセチル基、プロパノイル基、ブタノイル基、ピバロイル基、オクタノイル基、ベンゾイル基等を好ましく挙げる事ができる。アルコキシカルボニル基としては、t-ブトキシカルボニル基、t-アミロキシカルボニル基、1-メチル-1-シクロヘキシルオキシカルボニル基等の3級のアルコキシカルボニル基が挙げられる。アルコキシカルボニルメチル基としては、t-ブトキシカルボニルメチル基、t-アミロキシカルボニルメチル基、1-メチル-1-シクロヘキシルオキシカルボニルメチル基等の3級のアルコキシカルボニル基が挙げられる。

#### 【0034】

またアルキレン基としては、好ましくは置換基を有していても良いメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ヘキシレン基、オクチレン基等の炭素数1～8個のものが挙げられる。アルケニレン基としては、好ましくは置換基

を有していても良いエチレン基、プロピレン基、ブチレン基等の炭素数2～6個のものが挙げられる。シクロアルキレン基としては、好ましくは置換基を有していても良いシクロペンチレン基、シクロヘキシレン基等の炭素数5～8個のものが挙げられる。アリーレン基としては、好ましくは置換基を有していても良いフェニレン基、トリレン基、ナフチレン基等の炭素数6～15個のものが挙げられる。

## 【0035】

また $R_5 \sim R_7$ 、あるいは $R_{19} \sim R_{22}$ の2つが結合して形成した環としては、例えば3～8員環であり、具体的にはシクロプロパン環、シクロペンタン環、シクロヘキサン環、フラン環、ピラン環、ジオキソノール環、1,3-ジオキソラン環等が挙げられる。Zは単環又は多環の脂環式基を構成する原子団を表し、形成される脂環式基としては、単環型として炭素数3～8個のものであって、例えばシクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基を好ましく挙げる事ができる。多環型としては炭素数6～20個のものであって、例えばアダマンチル基、ノルボルニル基、イソボロニル基、カンファニル基、ジシクロペンチル基、 $\alpha$ -ピネル基、トリシクロデカニル基、テトシクロドデシル基、アンドロスタニル基等を好ましく挙げる事ができる

## 【0036】

またこれらの基に置換される置換基としては、アミノ基、アミド基、ウレイド基、ウレタン基、ヒドロキシ基、カルボキシ基等の活性水素を有するものや、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、アルコキシ基（メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等）、チオエーテル基、アシル基（アセチル基、プロパノイル基、ベンゾイル基等）、アシロキシ基（アセトキシ基、プロパノイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基等）、アルコキシカルボニル基（メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基等）、シアノ基、ニトロ基等が挙げられる。

## 【0037】

本発明（A）の樹脂に含まれる、酸の作用により分解しアルカリ可溶性を示す基としては、例えば $-O-C(R_{19})(R_{20})(R_{21})$ 、 $-O-C(R_{19})(R$

20) ( $\text{OR}_{22}$ )、 $-\text{O}-\text{COO}-\text{C}(\text{R}_{19})(\text{R}_{20})(\text{R}_{21})$ 、 $-\text{O}-\text{C}(\text{R}_{01})(\text{R}_{02})\text{COO}-\text{C}(\text{R}_{19})(\text{R}_{20})(\text{R}_{21})$ 、 $-\text{COO}-\text{C}(\text{R}_{19})(\text{R}_{20})(\text{R}_{21})$ 、 $-\text{COO}-\text{C}(\text{R}_{19})(\text{R}_{20})(\text{OR}_{22})$ 等が挙げられる。 $\text{R}_{19} \sim \text{R}_{22}$ は上記と同義であり、 $\text{R}_{01}$ 、 $\text{R}_{02}$ は水素原子、上記で示した置換基を有していても良いアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、もしくはアリール基を表す。

## 【0038】

好ましい具体例としては、 $t$ -ブチル基、 $t$ -アミル基、1-アルキル-1-シクロヘキシル基、2-アルキル-2-アダマンチル基、2-アダマンチル-2-プロピル基、2-(4-メチルシクロヘキシル)-2-プロピル基等の3級アルキル基のエーテル基又はエステル基、1-アルコキシ-1-エトキシ基、テトラヒドロピラニル基等のアセタール基又はアセタールエステル基、 $t$ -アルキルカーボネート基、 $t$ -アルキルカルボニルメトキシ基等が好ましく挙げられる。更に好ましくは、1-アルコキシ-1-エトキシ基、テトラヒドロピラニル基等のアセタール基である。

アセタール基の場合、酸分解性が大きく、併用する酸発生化合物の選択の幅が広がり、感度の向上、露光後加熱までの経時での性能変動等の点で有効である。特に好ましくはアセタール基の1-アルコキシ成分として上記パーフルオロアルキル基から由来するアルコキシ基を含有するアセタール基である。この場合、短波の露光光（例えば $\text{F}_2$ エキシマレーザー光の157nm）での透過性がいっそう向上させることができる。

## 【0039】

一般式(I)で示される繰り返し単位の含量の合計は、全ポリマー組成中において20～100モル%、好ましくは30～80モル%、更に好ましくは40～70モル%の範囲で使用される。

一般式(III)で表される繰り返し単位の含量は、全ポリマー組成中において0～80モル%、好ましくは20～60モル%、更に好ましくは30～50モル%の範囲で使用される。

一般式(IV)～(V)で表される繰り返し単位の含量は、全ポリマー組成中

において0～50モル%、好ましくは0～40モル%、更に好ましくは0～30モル%の範囲で使用される。

一般式(VI)～(VII)で表される繰り返し単位の含量は、全ポリマー組成中において0～60モル%、好ましくは10～50モル%、更に好ましくは20～40モル%の範囲で使用される。

#### 【0040】

本発明(A)の樹脂は、上記のような繰り返し構造単位以外にも、更に本発明のポジ型レジストの性能を向上させる目的で、他の重合性モノマーを共重合させても良い。

#### 【0041】

使用することができる共重合モノマーとしては、以下に示すものが含まれる。例えば、上記以外のアクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリル酸エステル類、メタクリルアミド類、アリル化合物、ビニルエーテル類、ビニルエステル類、スチレン類、クロトン酸エステル類などから選ばれる付加重合性不飽和結合を1個有する化合物である。

#### 【0042】

具体的には、例えばアクリル酸エステル類、例えばアルキル（アルキル基の炭素原子数は1～10のものが好ましい）アクリレート（例えば、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸アミル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸エチルヘキシル、アクリル酸オクチル、クロルエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート2, 2-ジメチルヒドロキシプロピルアクリレート、5-ヒドロキシペンチルアクリレート、トリメチロールプロパンモノアクリレート、ペンタエリスリトールモノアクリレート、グリシジルアクリレート、ベンジルアクリレート、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、など）アリールアクリレート（例えばフェニルアクリレートなど）；

#### 【0043】

メタクリル酸エステル類、例えば、アルキル（アルキル基の炭素原子数は1～10のものが好ましい）メタクリレート（例えば、メチルメタクリレート、エチル

メタクリレート、プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、アミルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、クロルベンジルメタクリレート、オクチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、4-ヒドロキシブチルメタクリレート、5-ヒドロキシペンチルメタクリレート、2, 2-ジメチル-3-ヒドロキシプロピルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタクリレート、ペンタエリスリトールモノメタクリレート、グリシジルメタクリレート、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレートなど）、アリアルメタクリレート（例えば、フェニルメタクリレート、クレジルメタクリレート、ナフチルメタクリレートなど）；

## 【0044】

アクリルアミド類、例えば、アクリルアミド、N-アルキルアクリルアミド、（アルキル基としては、炭素原子数1～10のもの、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、t-ブチル基、ヘブチル基、オクチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基、ヒドロキシエチル基、ベンジル基などがある。）、N-アリアルアクリルアミド（アリアル基としては、例えばフェニル基、トリル基、ニトロフェニル基、ナフチル基、シアノフェニル基、ヒドロキシフェニル基、カルボキシフェニル基などがある。）、N, N-ジアルキルアクリルアミド（アルキル基としては、炭素原子数1～10のもの、例えば、メチル基、エチル基、ブチル基、イソブチル基、エチルヘキシル基、シクロヘキシル基などがある。）、N, N-ジアリアルアクリルアミド（アリアル基としては、例えばフェニル基などがある。）、N-メチル-N-フェニルアクリルアミド、N-ヒドロキシエチル-N-メチルアクリルアミド、N-2-アセトアミドエチル-N-アセチルアクリルアミドなど；

## 【0045】

メタクリルアミド類、例えば、メタクリルアミド、N-アルキルメタクリルアミド（アルキル基としては、炭素原子数1～10のもの、例えば、メチル基、エチル基、t-ブチル基、エチルヘキシル基、ヒドロキシエチル基、シクロヘキシル基などがある。）、N-アリアルメタクリルアミド（アリアル基としては、フェ



ニル基などがある。)、N, N-ジアルキルメタクリルアミド(アルキル基としては、エチル基、プロピル基、ブチル基などがある。)、N, N-ジアリールメタクリルアミド(アリール基としては、フェニル基などがある。)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルメタクリルアミド、N-メチル-N-フェニルメタクリルアミド、N-エチル-N-フェニルメタクリルアミドなど; アリル化合物、例えば、アリルエステル類(例えば、酢酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸アリル、ラウリン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステアリン酸アリル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、乳酸アリルなど)、アリルオキシエタノールなど;

## 【 0 0 4 6 】

ビニルエーテル類、例えば、アルキルビニルエーテル(例えば、ヘキシルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキシルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、エトキシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエーテル、1-メチル-2, 2-ジメチルプロピルビニルエーテル、2-エチルブチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ジエチレングリコールビニルエーテル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジエチルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニルエーテル、ベンジルビニルエーテル、テトラヒドロフルフリルビニルエーテルなど)、ビニルアリールエーテル(例えばビニルフェニルエーテル、ビニルトリルエーテル、ビニルクロルフェニルエーテル、ビニル-2, 4-ジクロルフェニルエーテル、ビニルナフチルエーテル、ビニルアントラニルエーテルなど);

## 【 0 0 4 7 】

ビニルエステル類、例えば、ビニルブチレート、ビニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセテート、ビニルジエチルアセテート、ビニルバレート、ビニルカプロエート、ビニルクロルアセテート、ビニルジクロルアセテート、ビニルメトキシアセテート、ビニルブトキシアセテート、ビニルフェニルアセテート、ビニルアセトアセテート、ビニルラクテート、ビニル- $\beta$ -フェニルブチレート、ビニルシクロヘキシルカルボキシレート、安息香酸ビニル、サルチル酸ビニル、クロル安息香酸ビニル、テトラクロル安息香酸ビニル、ナフトエ酸ビニルなど;

## 【0048】

スチレン類、例えば、スチレン、アルキルスチレン（例えば、メチルスチレン、ジメチルスチレン、トリメチルスチレン、エチルスチレン、ジエチルスチレン、イソプロピルスチレン、ブチルスチレン、ヘキシルスチレン、シクロヘキシルスチレン、デシルスチレン、ベンジルスチレン、クロルメチルスチレン、トリフルオルメチルスチレン、エトキシメチルスチレン、アセトキシメチルスチレンなど）、アルコキシスチレン（例えば、メトキシスチレン、4-メトキシ-3-メチルスチレン、ジメトキシスチレンなど）、ハロゲンスチレン（例えば、クロルスチレン、ジクロルスチレン、トリクロルスチレン、テトラクロルスチレン、ペンタクロルスチレン、ブロムスチレン、ジブロムスチレン、ヨードスチレン、フルオルスチレン、トリフルオルスチレン、2-ブロム-4-トリフルオルメチルスチレン、4-フルオール-3-トリフルオルメチルスチレンなど）、カルボキシスチレン、ビニルナフタレン；

## 【0049】

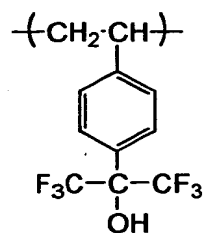
クロトン酸エステル類、例えば、クロトン酸アルキル（例えば、クロトン酸ブチル、クロトン酸ヘキシル、グリセリンモノクロトネートなど）；イタコン酸ジアルキル類（例えば、イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、イタコン酸ジブチルなど）；マレイン酸あるいはフマル酸のジアルキルエステル類（例えば、ジメチルマレレート、ジブチルフマレートなど）等がある。その他、一般的には共重合可能である付加重合性不飽和化合物であればよい。

## 【0050】

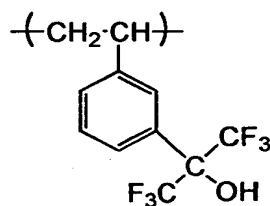
以下に、一般式（I）で表される繰り返し構造単位の実例を示すが、本発明がこれに限定されるものではない。

## 【0051】

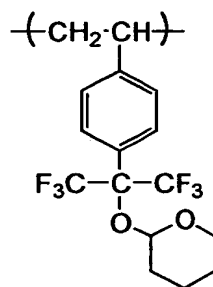
【化 13】



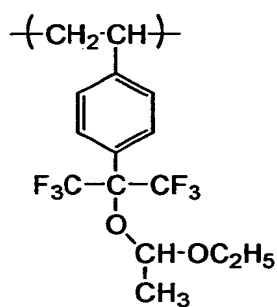
(I-1)



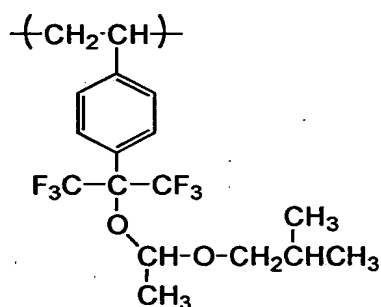
(I-2)



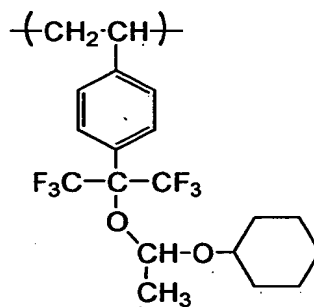
(I-3)



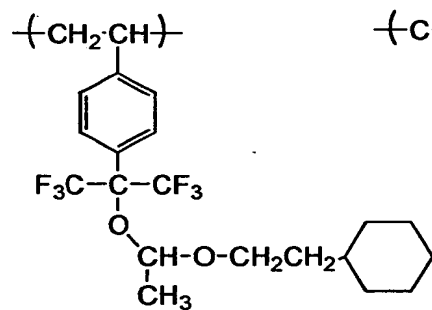
(I-4)



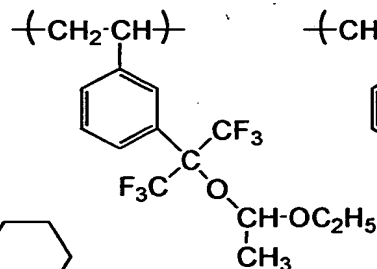
(I-5)



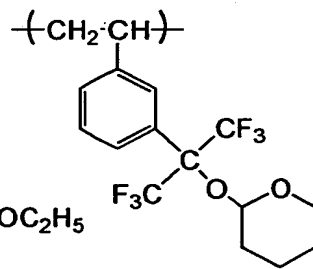
(I-6)



(I-7)



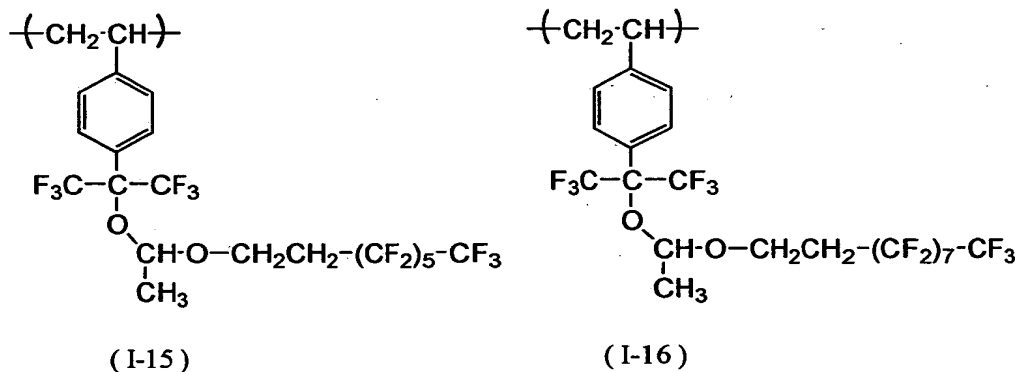
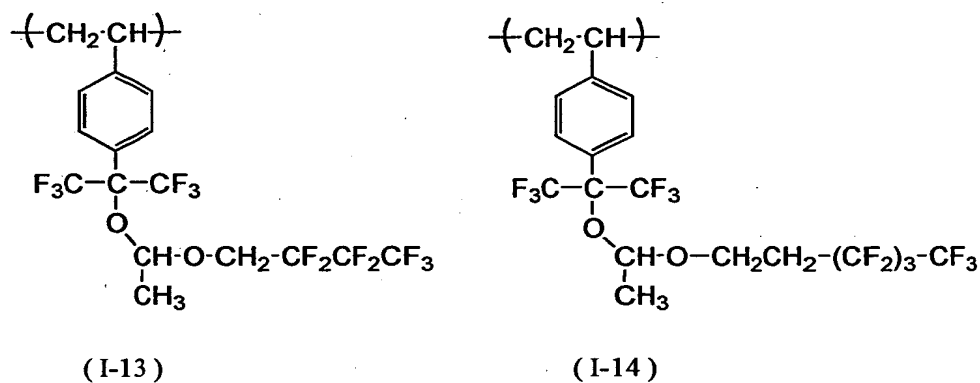
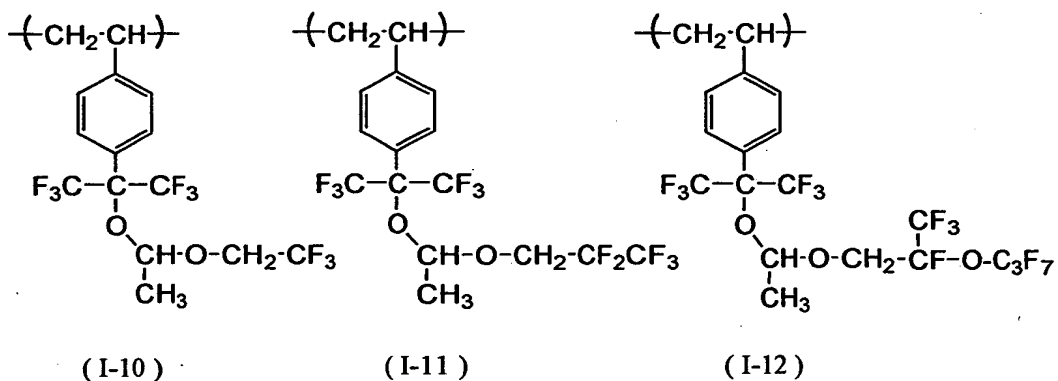
(I-8)



(I-9)

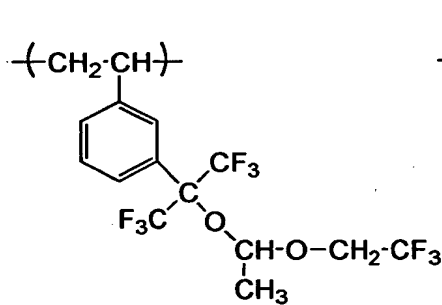
【0052】

【化 14】

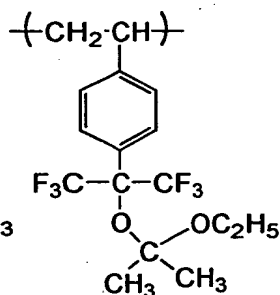


【0053】

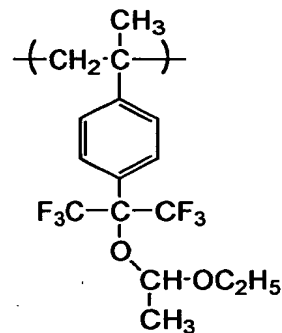
【化 15】



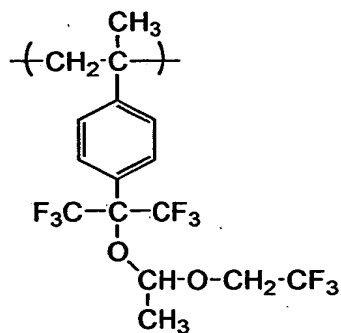
(I-17)



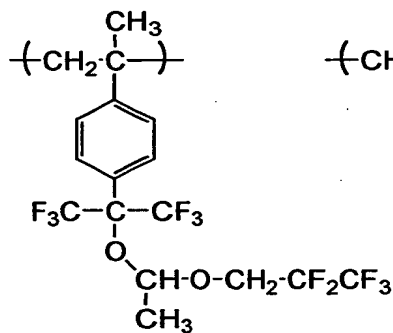
(I-18)



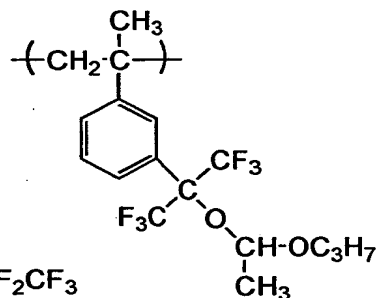
(I-19)



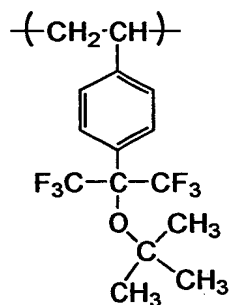
(I-20)



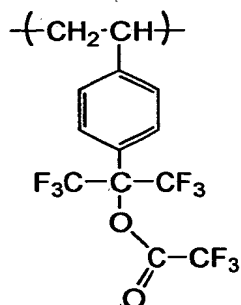
(I-21)



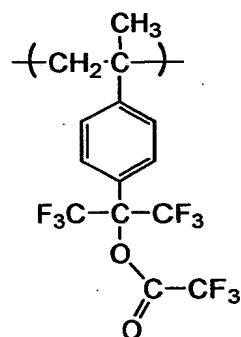
(I-22)



(I-23)



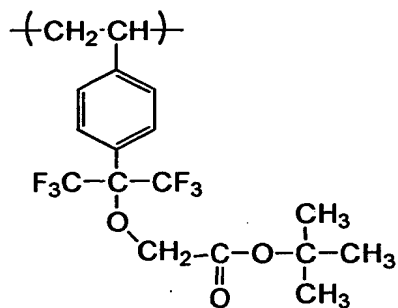
(I-24)



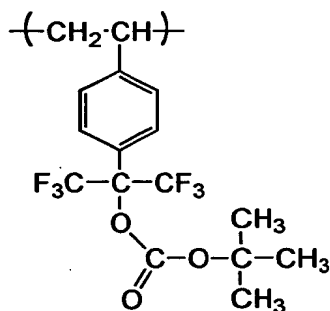
(I-25)

【0054】

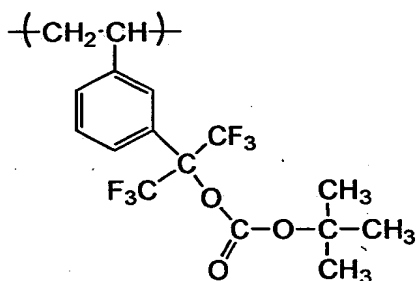
【化 16】



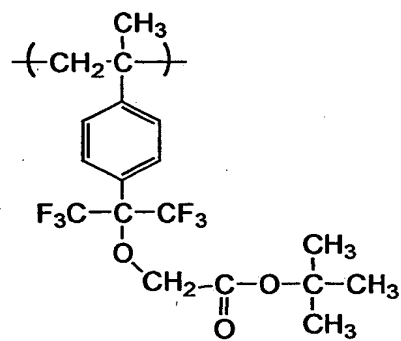
(I-26)



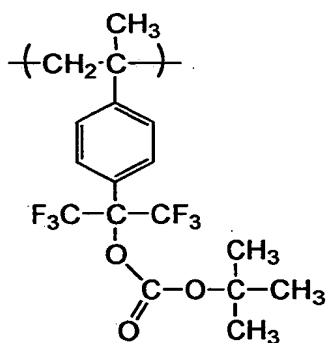
(I-27)



(I-28)



(I-29)



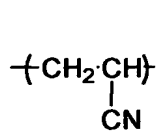
(I-30)

【0055】

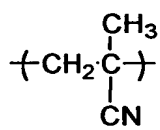
また一般式 (I I I) ~ (V I I) で表される繰り返し構造単位の実例を示すが、本発明がこれに限定されるものではない。

【0056】

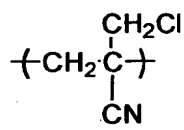
【化 17】



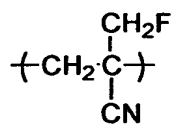
(III-1)



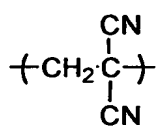
(III-2)



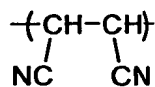
(III-3)



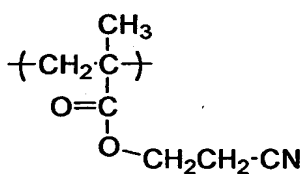
(III-4)



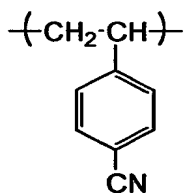
(III-5)



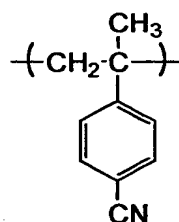
(III-6)



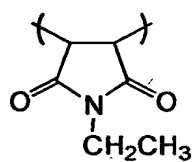
(III-7)



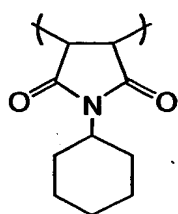
(III-8)



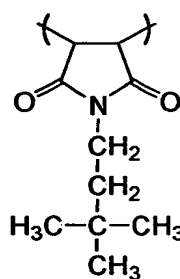
(III-9)



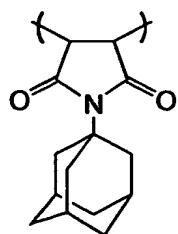
(V-1)



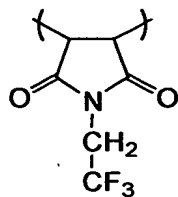
(V-2)



(V-3)



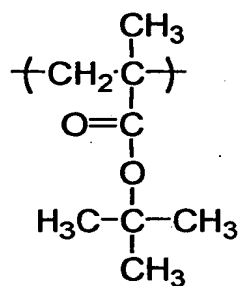
(V-4)



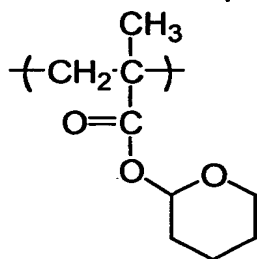
(V-5)

【0057】

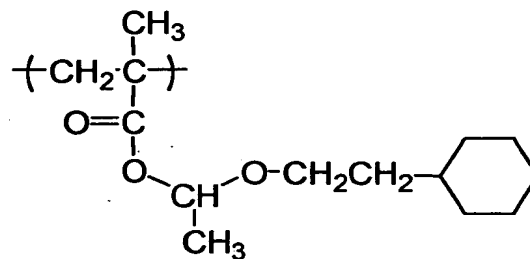
【化 18】



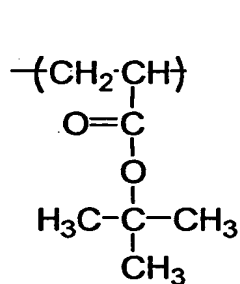
(B-1)



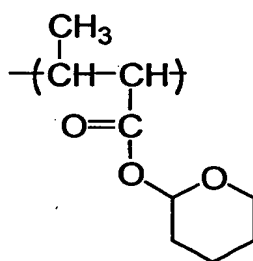
(B-2)



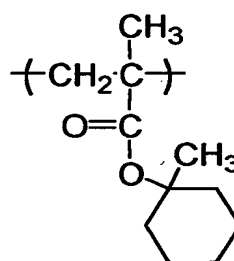
(B-3)



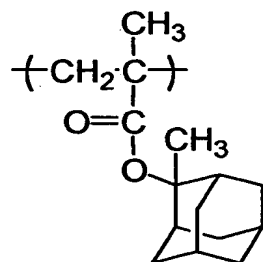
(B-4)



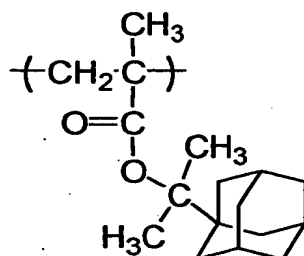
(B-5)



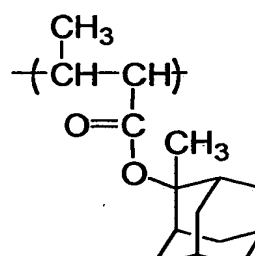
(B-6)



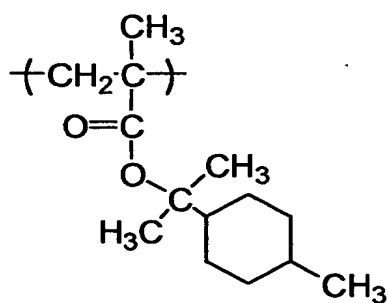
(B-7)



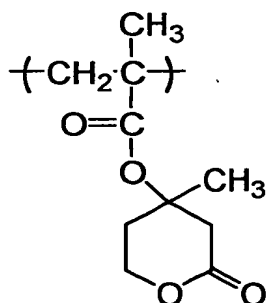
(B-8)



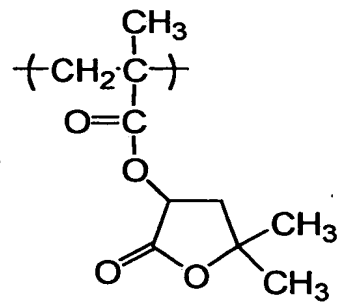
(B-9)



(B-10)



(B-11)

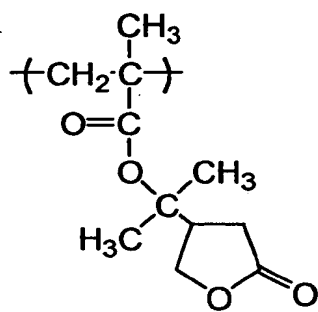


(B-12)

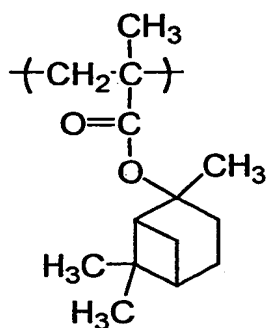


【0058】

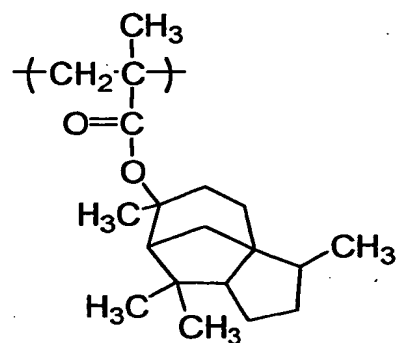
【化19】



(B-13)



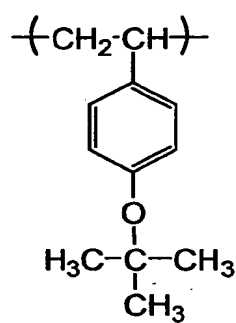
(B-14)



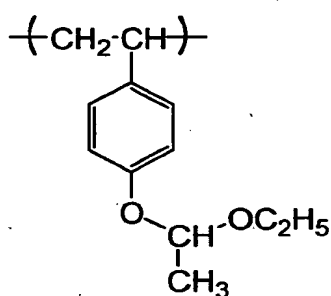
(B-15)

【0059】

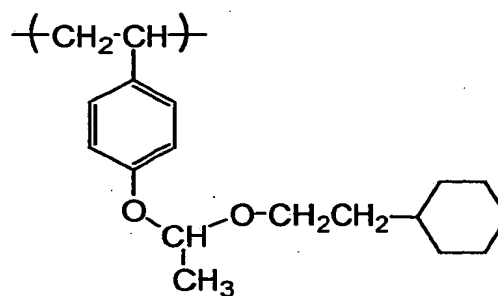
【化20】



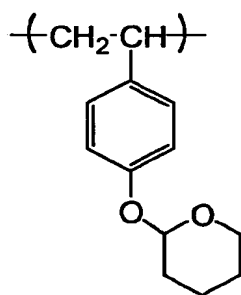
(B-31)



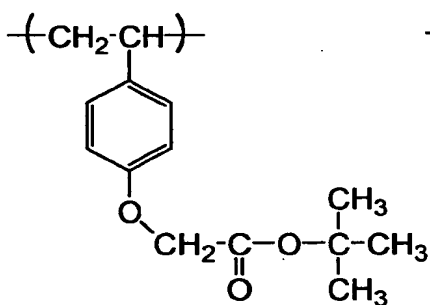
(B-32)



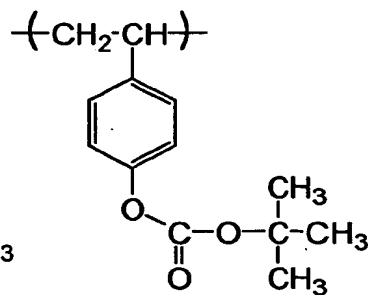
(B-33)



(B-34)



(B-35)



(B-36)

【0060】

上記具体例で表される繰り返し構造単位は、各々1種で使用しても良いし、複

数を混合して用いても良い。

上記繰り返し構造単位を有する本発明の樹脂 (A) の好ましい分子量は、重量平均で 1, 0 0 0 ~ 2 0 0, 0 0 0 であり、更に好ましくは 3, 0 0 0 ~ 2 0, 0 0 0 の範囲で使用される。分子量分布は 1 ~ 1 0 であり、好ましくは 1 ~ 3、更に好ましくは 1 ~ 2 の範囲のものが使用される。分子量分布の小さいものほど、解像度、レジスト形状、及びレジストパターンの側壁がスムーズであり、ラフネス性に優れる。本発明の樹脂 (A) の添加量は組成物の全固形分を基準として、5 0 ~ 9 9. 5 重量%、好ましくは 6 0 ~ 9 8 重量%、更に好ましくは 6 5 ~ 9 5 重量%の範囲で使用される。

#### 【 0 0 6 1 】

[ 2 ] 本発明 (B) の活性光線又は放射線の照射により、酸を発生する化合物

本発明で使用される活性光線又は放射線の照射により分解して酸を発生する化合物としては、光カチオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている公知の光 ( 4 0 0 ~ 2 0 0 n m の紫外線、遠紫外線、特に好ましくは、g 線、h 線、i 線、K r F エキシマレーザー光)、A r F エキシマレーザー光、電子線、X 線、分子線又はイオンビームにより酸を発生する化合物及びそれらの混合物を適宜に選択して使用することができる。

#### 【 0 0 6 2 】

また、その他の本発明に用いられる活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物としては、たとえば S. I. Schlesinger, Photogr. Sci. Eng., 18, 387 (1974)、T. S. Bal et al, Polymer, 21, 423(1980)等に記載のジアソニウム塩、米国特許第4,069,055号、同4,069,056号、同 Re 27,992号、特開平3-140140号等に記載のアンモニウム塩、D. C. Necker et al, Macromolecules, 17, 2468(1984)、C. S. Wen et al, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct(1988)、米国特許第4,069,055号、同4,069,056号等に記載のホスホニウム塩、J. V. Crivello et al, Macromolecules, 10(6), 1307(1977)、Chem. & Eng. News, Nov. 28, p31(1988)、欧州特許第104,143号、同339,049号、同第410,201号、特開平2-150848号、特開平2-296514 号等に記載のヨードニウム塩、J. V.

Crivello et al, Polymer J. 17, 73(1985)、J. V. Crivello et al., J. Org. Chem., 43, 3055(1978)、W. R. Watt et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 22, 1789(1984)、J. V. Crivello et al, Polymer Bull., 14, 279(1985)、J. V. Crivello et al, Macromolecules, 14(5), 1141(1981)、J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 2877(1979)、欧州特許第370,693号、同161,811号、同410,201号、同339,049号、同233,567号、同297,443号、同297,442号、米国特許第4,933,377号、同3,902,114号、同4,760,013号、同4,734,444号、同2,833,827号、獨国特許第2,904,626号、同3,604,580号、同3,604,581号等に記載のスルホニウム塩、J. V. Crivello et al, Macromolecules, 10(6), 1307(1977)、J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 1047(1979)等に記載のセレノニウム塩、C. S. Wen et al, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct(1988)等に記載のアルソニウム塩等のオニウム塩、米国特許第3,905,815号、特公昭46-4605号、特開昭48-36281号、特開昭55-32070号、特開昭60-239736号、特開昭61-169835号、特開昭61-169837号、特開昭62-58241号、特開昭62-212401号、特開昭63-70243号、特開昭63-298339号等に記載の有機ハロゲン化合物、K. Meier et al, J. Rad. Curing, 13(4), 26(1986)、T. P. Gill et al, Inorg. Chem., 19, 3007(1980)、D. Astruc, Acc. Chem. Res., 19(12), 377(1986)、特開平2-161445号等に記載の有機金属／有機ハロゲン化物、S. Hayase et al, J. Polymer Sci., 25, 753(1987)、E. Reichmanis et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 23, 1(1985)、Q. Q. Zhu et al, J. Photochem., 36, 85, 39, 317(1987)、B. Amit et al, Tetrahedron Lett., (24)2205(1973)、D. H. R. Barton et al, J. Chem Soc., 3571(1965)、P. M. Collins et al, J. Chem. Soc., Perkin I, 1695(1975)、M. Rudinstein et al, Tetrahedron Lett., (17), 1445(1975)、J. W. Walker et al, J. Am. Chem. Soc., 110, 7170(1988)、S. C. Busman et al, J. Imaging Technol., 11(4), 191(1985)、H. M. Houlihan et al, Macromolecules, 21, 2001(1988)、P. M. Collins et al, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 532(1972)、S. Hayase et al, Macromolecules, 18, 1799(1985)、E. Reichmanis et al, J. Electrochem. Soc., Solid State Sci. Technol., 130(6)、F. M. Houlihan et al, Macromol

ules, 21,2001(1988)、欧州特許第0290,750号、同046,083号、同156,535号、同271,851号、同0,388,343号、米国特許第3,901,710号、同4,181,531号、特開昭60-198538号、特開昭53-133022号等に記載のO-ニトロベンジル型保護基を有する光酸発生剤、M.TUNOOKA et al, Polymer Preprints Japan, 35(8)、G. Berner et al, J. Rad. Curing, 13(4)、W. J. Mijs et al, Coating Technol., 55(697), 45(1983)、Akzo、H. Adachi et al, Polymer Preprints, Japan, 37(3)、欧州特許第0199,672号、同84515号、同044,115号、同618,564号、同0101,122号、米国特許第4,371,605号、同4,431,774号、特開昭64-18143号、特開平2-245756号、特開平3-140109号等に記載のイミノスルフォネート等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化合物、特開昭61-166544号等に記載のジスルホン化合物を挙げることができる。

## 【0063】

また、これらの活性光線又は放射線の照射により酸を発生する基、あるいは化合物をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した化合物、たとえば、M. E. Woodhouse et al, J. Am. Chem. Soc., 104, 5586(1982)、S. P. Pappas et al, J. Imaging Sci., 30(5), 218(1986)、S. Kondo et al, Makromol. Chem., Rapid Commun., 9, 625(1988)、Y. Yamada et al, Makromol. Chem., 152, 153, 163(1972)、J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 3845(1979)、米国特許第3,849,137号、獨国特許第3914407、特開昭63-26653号、特開昭55-164824号、特開昭62-69263号、特開昭63-146038号、特開昭63-163452号、特開昭62-153853号、特開昭63-146029号等に記載の化合物を用いることができる。

## 【0064】

さらにV. N. R. Pillai, Synthesis, (1), 1(1980)、A. Abad et al, Tetrahedron Lett., (47)4555(1971)、D. H. R. Barton et al, J. Chem. Soc., (C), 329(1970)、米国特許第3,779,778号、欧州特許第126,712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

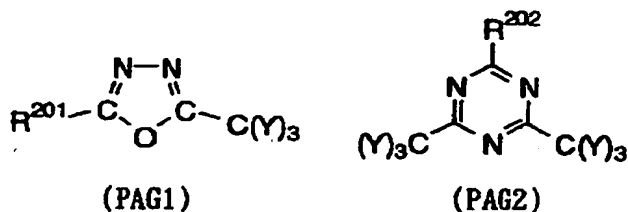
## 【0065】

上記活性光線又は放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の中で、特に有効に用いられるものについて以下に説明する。

(1) トリハロメチル基が置換した下記一般式 (PAG1) で表されるオキサゾール誘導体又は一般式 (PAG2) で表される S-トリアジン誘導体。

【0066】

【化21】



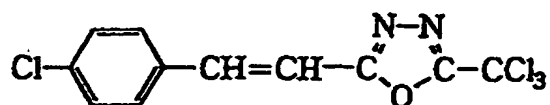
【0067】

式中、 $R^{201}$ は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、 $R^{202}$ は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、アルキル基、 $-C(Y)_3$ を示す。Yは塩素原子又は臭素原子を示す。

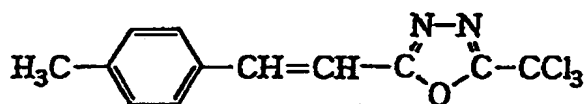
具体的には以下の化合物を挙げるができるがこれらに限定されるものではない。

【0068】

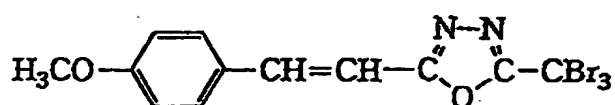
【化 2 2】



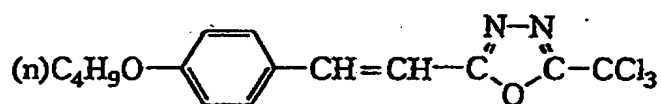
(PAG1-1)



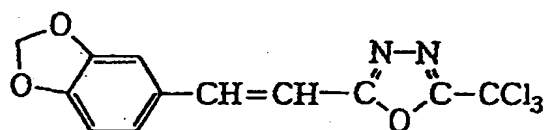
(PAG1-2)



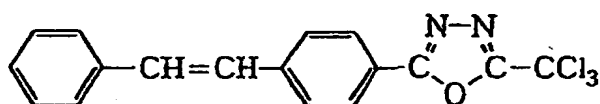
(PAG1-3)



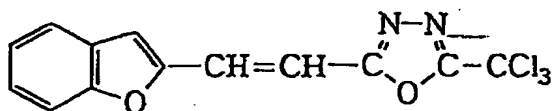
(PAG1-4)



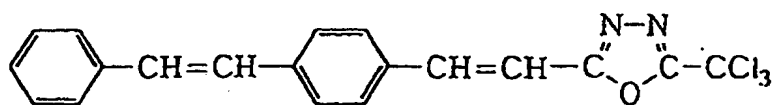
(PAG1-5)



(PAG1-6)



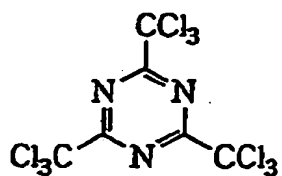
(PAG1-7)



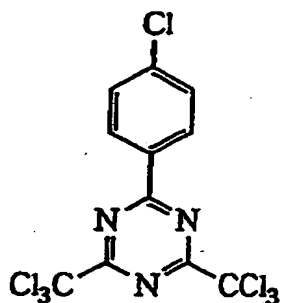
(PAG1-8)

【0069】

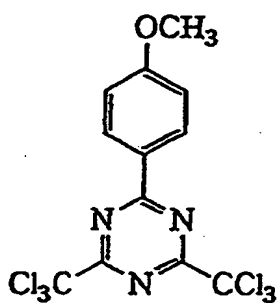
【化 23】



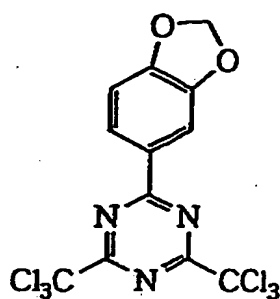
(PAG2-1)



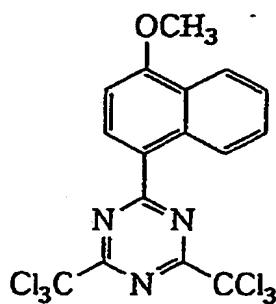
(PAG2-2)



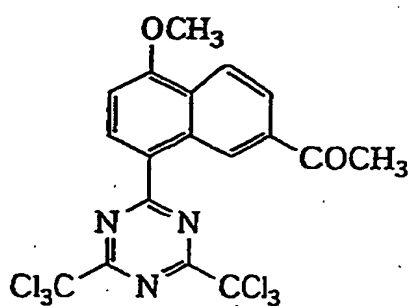
(PAG2-3)



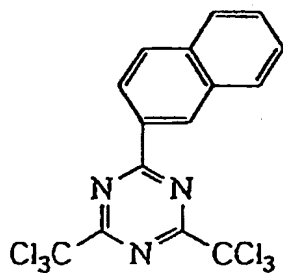
(PAG2-4)



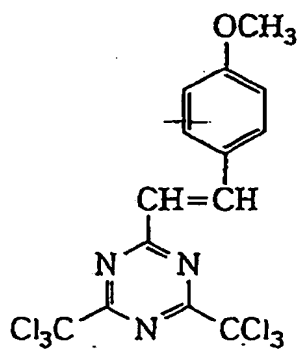
(PAG2-5)



(PAG2-6)



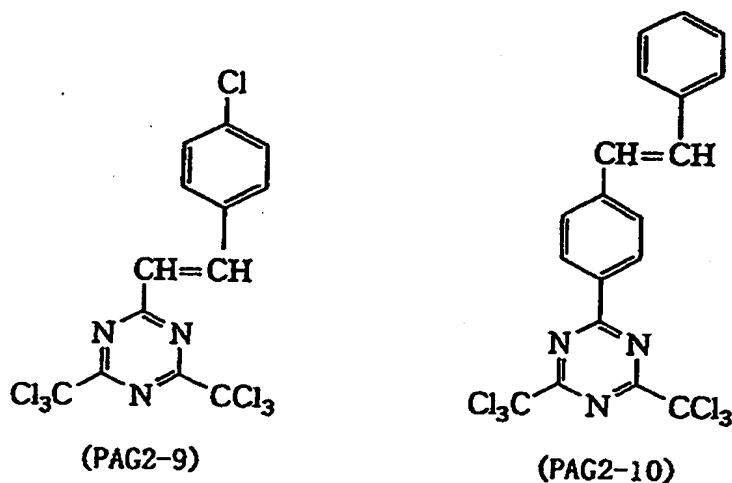
(PAG2-7)



(PAG2-8)

【0070】

【化 24】

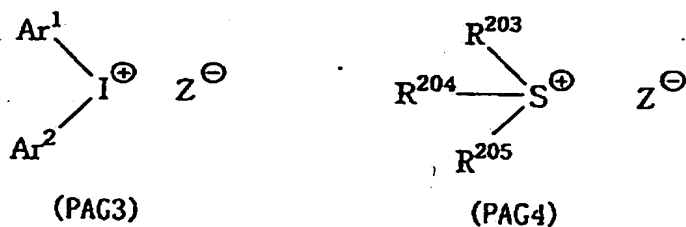


【0071】

(2) 下記的一般式 (PAG3) で表されるヨードニウム塩、又は一般式 (PAG4) で表されるスルホニウム塩。

【0072】

【化 25】



【0073】

ここで式  $Ar^1$ 、 $Ar^2$  は、各々独立、に置換もしくは未置換のアリール基を示す。好ましい置換基としては、アルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基、ニトロ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ヒドロキシ基、メルカプト基及びハロゲン原子が挙げられる。

【0074】

$R^{203}$ 、 $R^{204}$ 、 $R^{205}$  は、各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。好ましくは、炭素数 6～14 のアリール基、炭素数 1～8 のアルキル基及びそれらの置換誘導体である。好ましい置換基としては、アリール基



に対しては炭素数 1～8 のアルコキシ基、炭素数 1～8 のアルキル基、シクロアルキル基、ニトロ基、カルボキシ基、メルカプト基、ヒドロキシ基及びハロゲン原子であり、アルキル基に対しては炭素数 1～8 のアルコキシ基、カルボキシ基、アルコシキカルボニル基である。

## 【0075】

$Z^-$  はアニオンを表し、具体的には置換基を有していても良いアルキルスルホン酸、シクロアルキルスルホン酸、パーフルオロアルキルスルホン酸、アリールスルホン酸（例えば置換基を有していても良いベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸、アントラセンスルホン酸）等の各アニオンが挙げられる。

## 【0076】

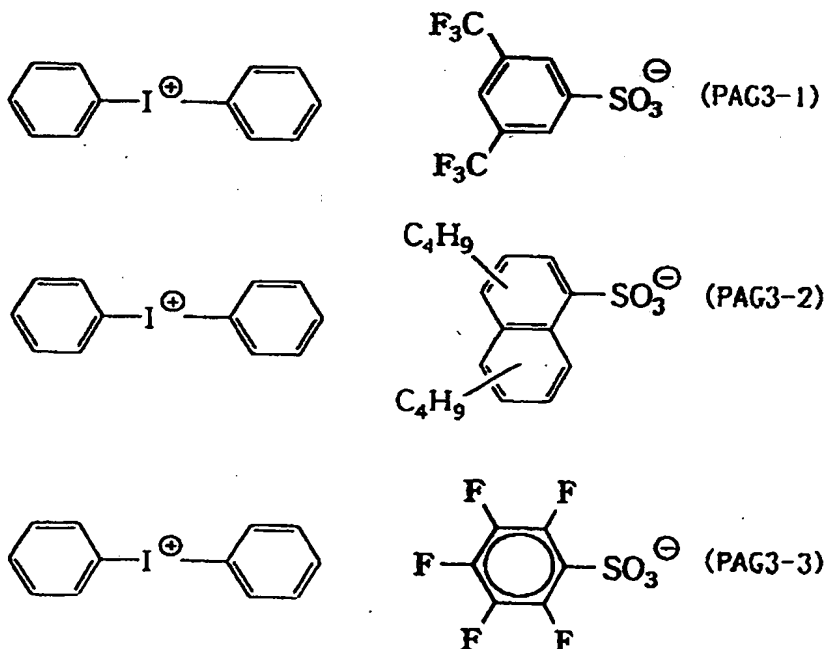
また  $R^{203}$ 、 $R^{204}$ 、 $R^{205}$  のうちの 2 つ及び  $Ar^1$ 、 $Ar^2$  はそれぞれの単結合又は置換基を介して結合してもよい。

## 【0077】

具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

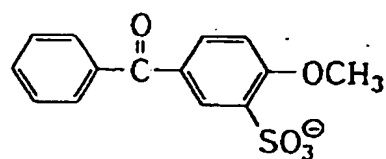
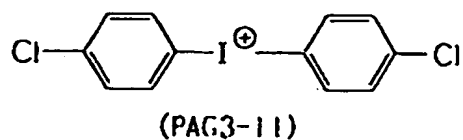
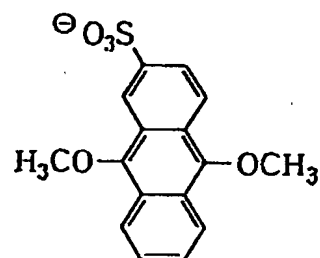
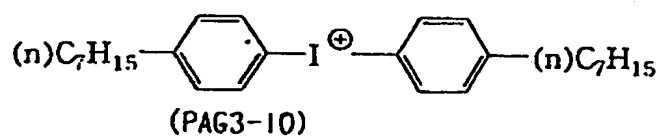
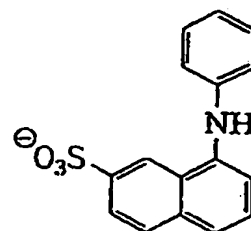
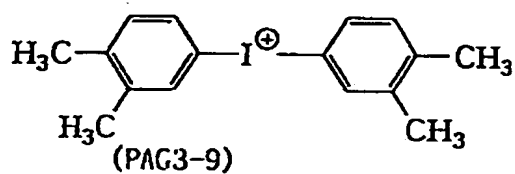
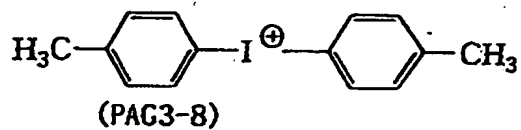
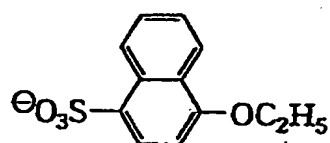
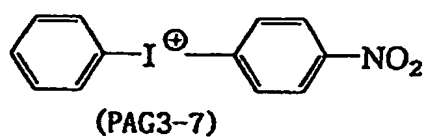
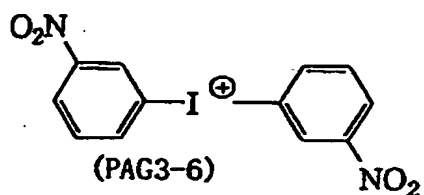
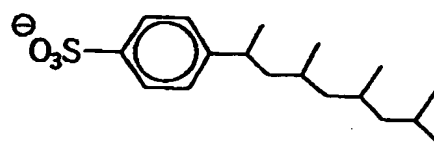
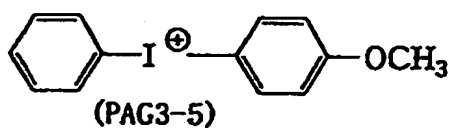
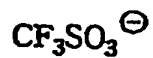
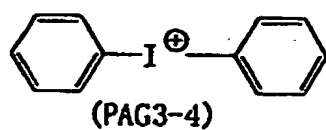
## 【0078】

## 【化 26】



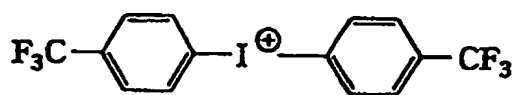
【0079】

【化27】

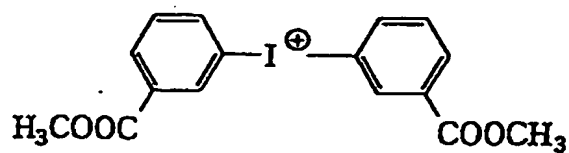
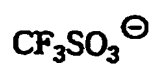


【0080】

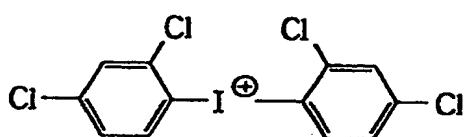
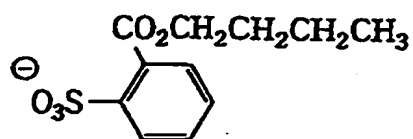
【化 28】



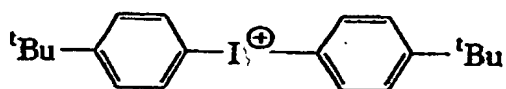
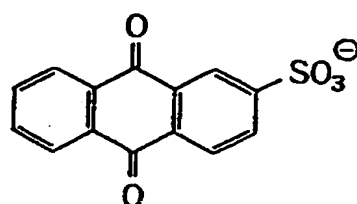
(PAG3-12)



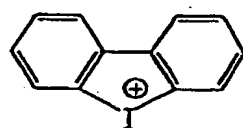
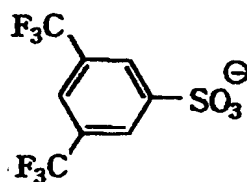
(PAG3-13)



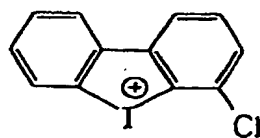
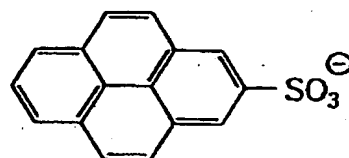
(PAG3-14)



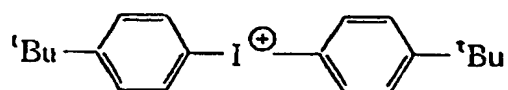
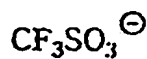
(PAG3-15)



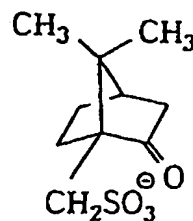
(PAG3-16)



(PAG3-17)

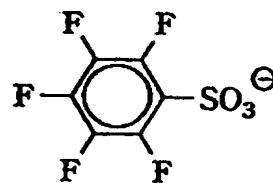
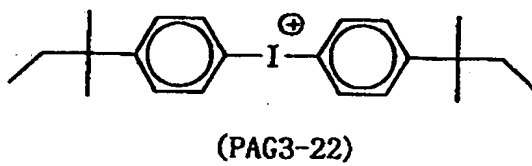
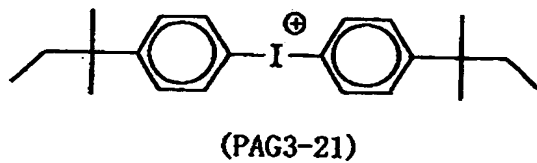
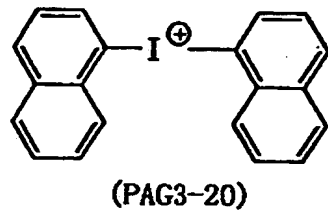
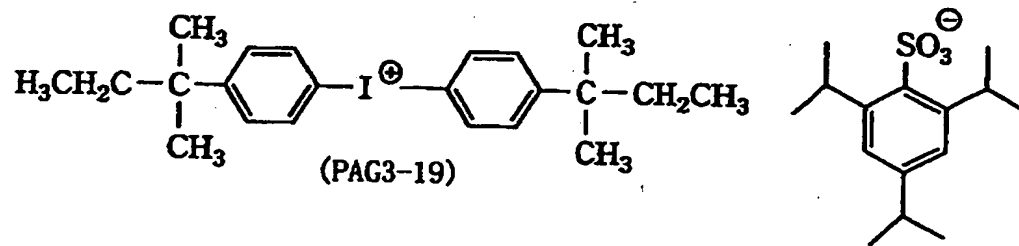


(PAG3-18)



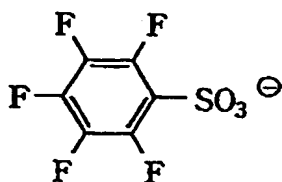
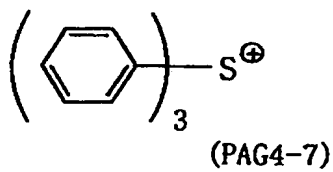
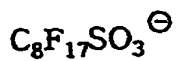
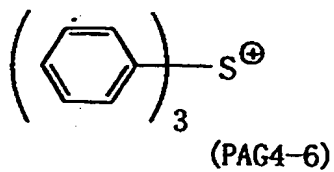
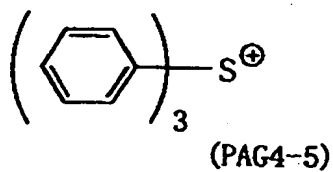
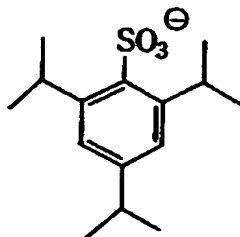
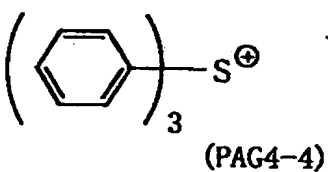
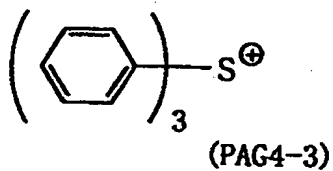
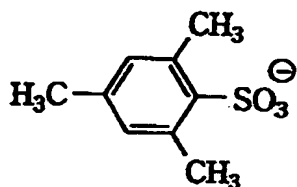
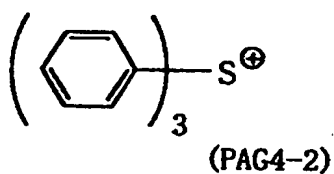
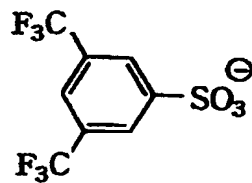
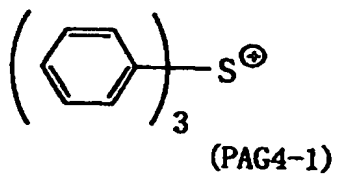
【0081】

【化29】



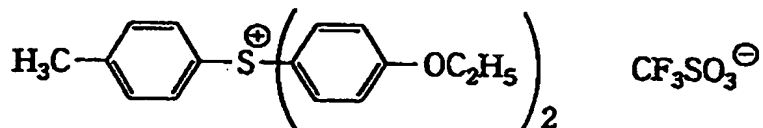
【0082】

【化30】

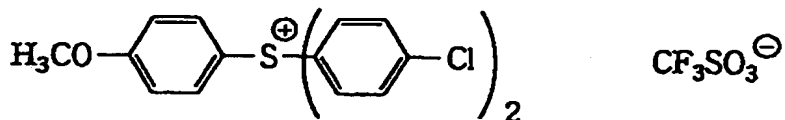


【0083】

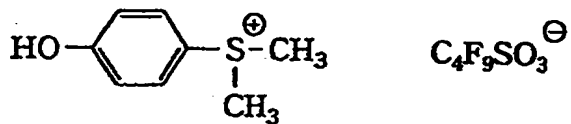
【化 3 1】



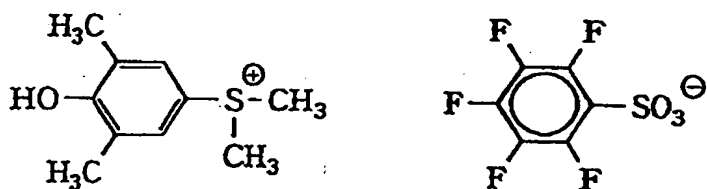
(PAG4-8)



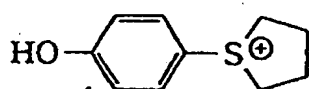
(PAG4-9)



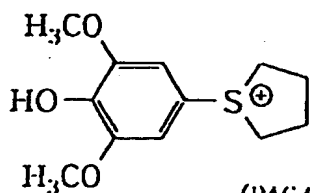
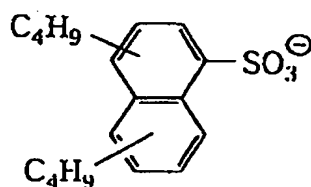
(PAG4-10)



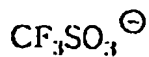
(PAG4-11)



(PAG4-12)

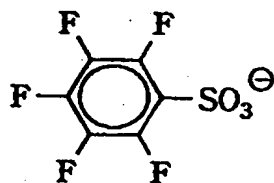
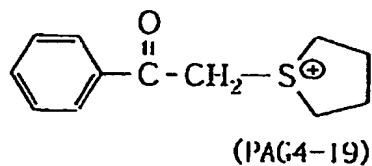
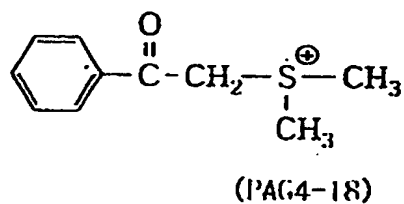
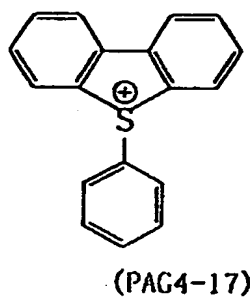
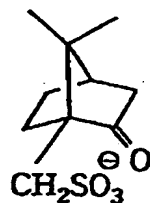
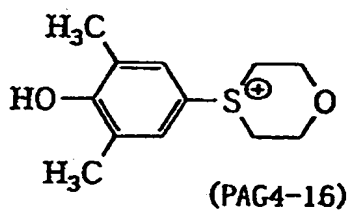
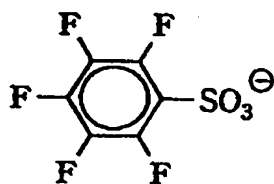
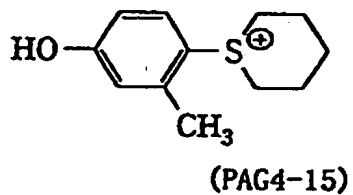
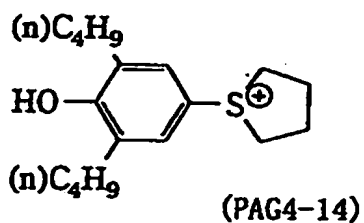


(PAG4-13)



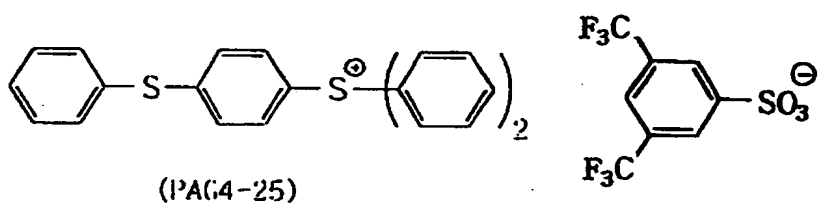
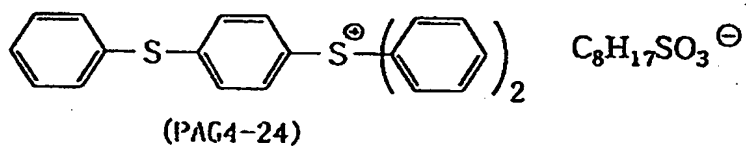
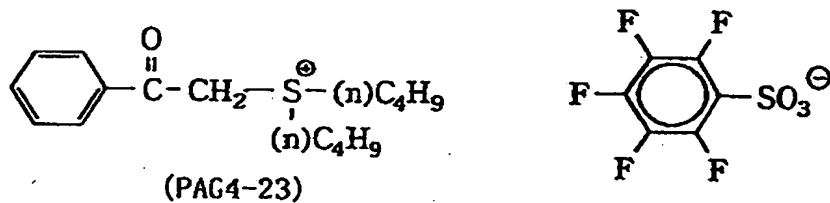
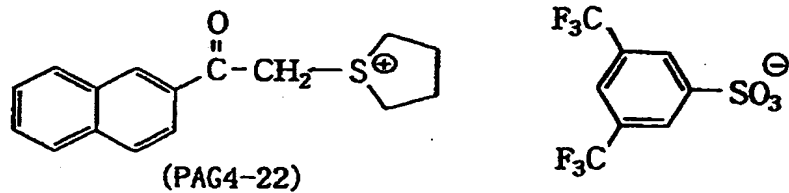
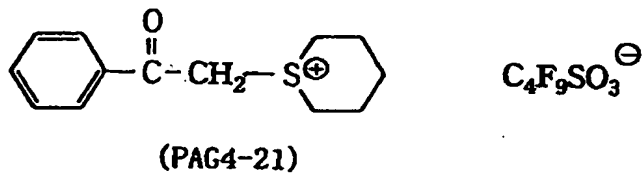
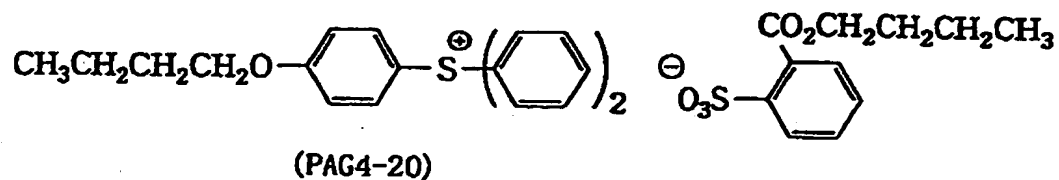
【 0 0 8 4 】

【化 3 2】



【0085】

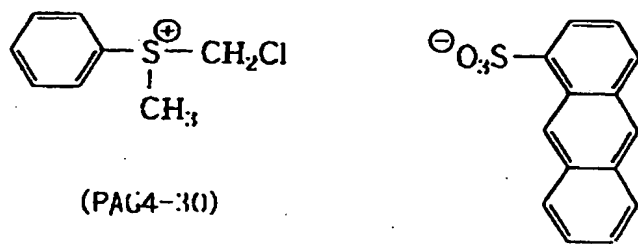
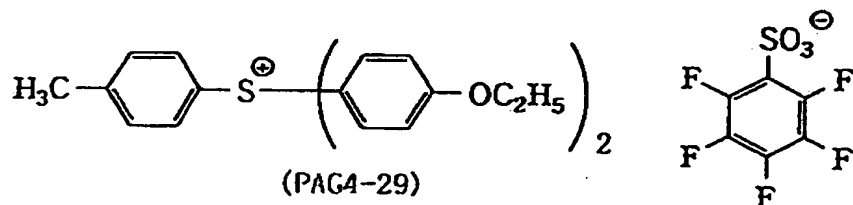
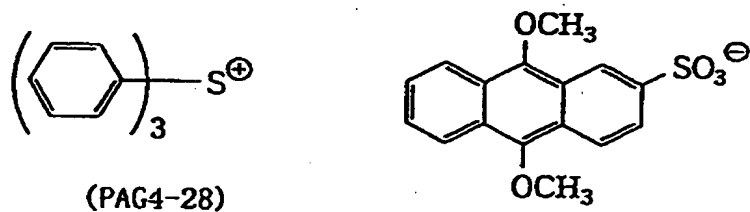
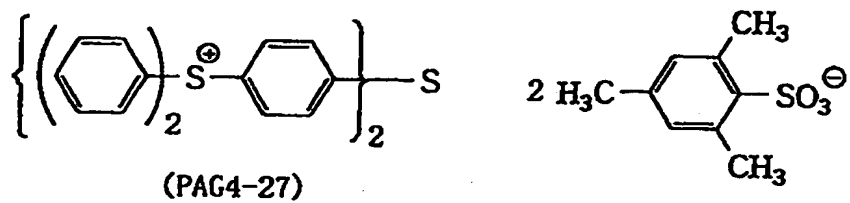
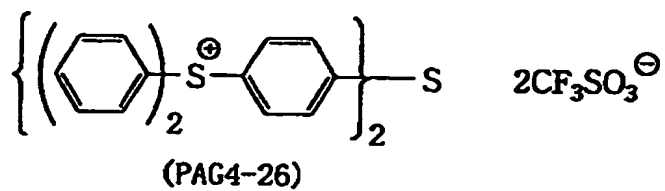
【化 3 3】



【0086】

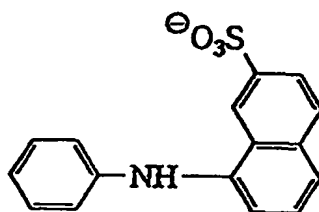
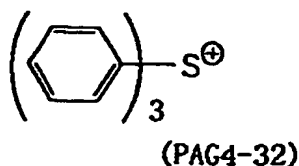
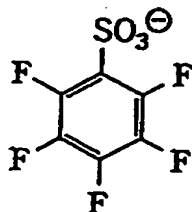
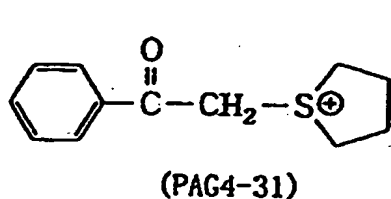


【化 34】



【0087】

【化 3 5】



【0088】

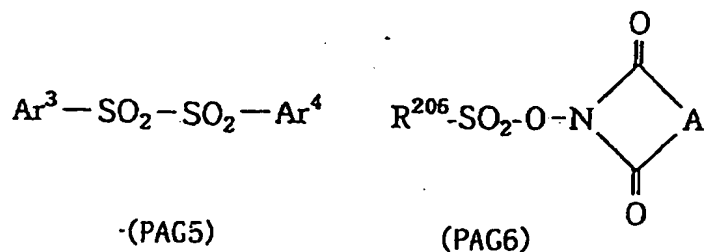
一般式 (PAG 3)、(PAG 4) で示される上記オニウム塩は公知であり、例えば J. W. Knapczyk et al, J. Am. Chem. Soc., 91, 145(1969)、A. L. Maycock et al, J. Org. Chem., 35, 2532,(1970)、E. Goethas et al, Bull. Soc. Chem. Belg., 73, 546,(1964)、H. M. Leicester, J. Am. Chem. Soc., 51, 3587(1929)、J. V. Crivello et al, J. Polym. Chem. Ed., 18, 2677(1980)、米国特許第2,807,648号及び同4,247,473号、特開昭53-101331号等に記載の方法により合成することができる。

【0089】

(3) 下記一般式 (PAG 5) で表されるジスルホン誘導体又は一般式 (PAG 6) で表されるイミノスルホネート誘導体。

【0090】

【化 3 6】



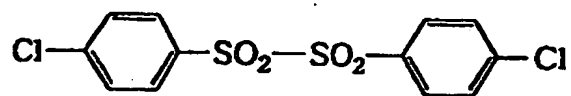
【0091】

式中、 $Ar^3$ 、 $Ar^4$ は各々独立に置換もしくは未置換のアリール基を示す。 $R^{206}$ は置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基を示す。

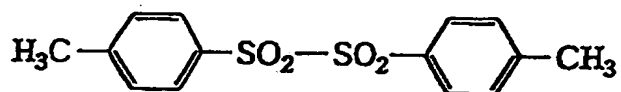
具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0092】

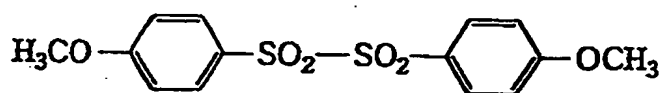
【化 37】



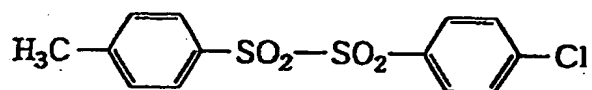
(PAG5-1)



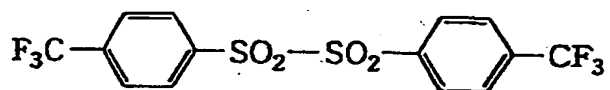
(PAG5-2)



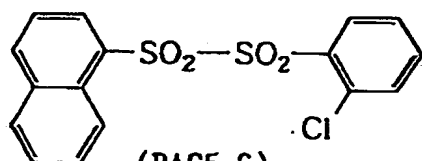
(PAG5-3)



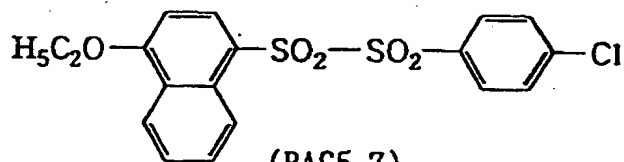
(PAG5-4)



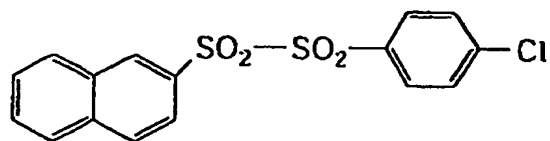
(PAG5-5)



(PAG5-6)



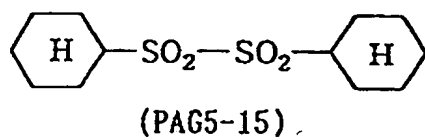
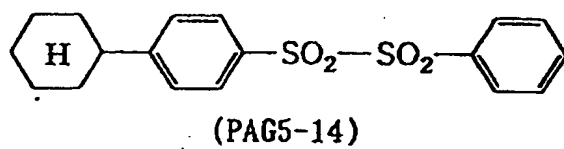
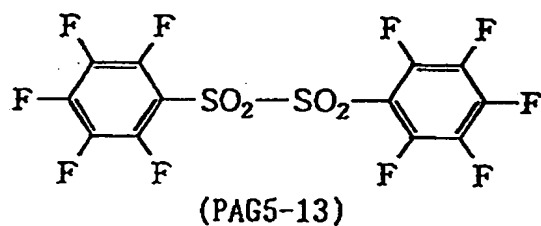
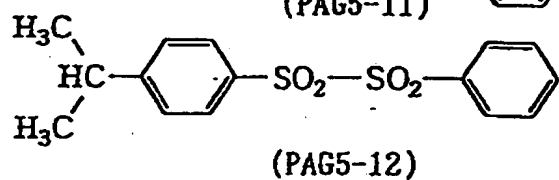
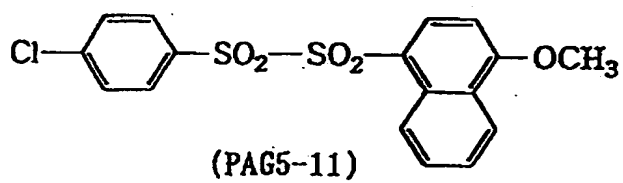
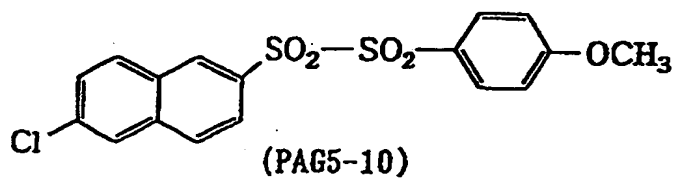
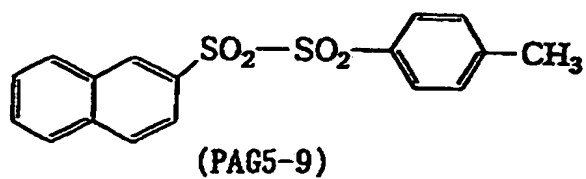
(PAG5-7)



(PAG5-8)

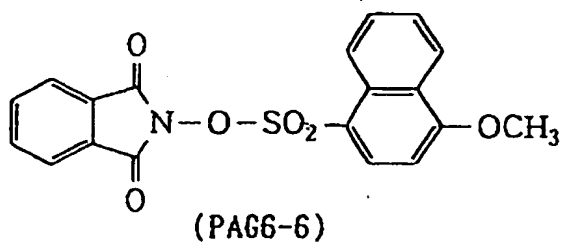
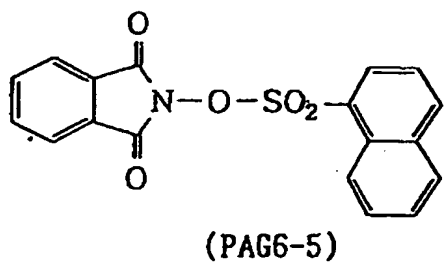
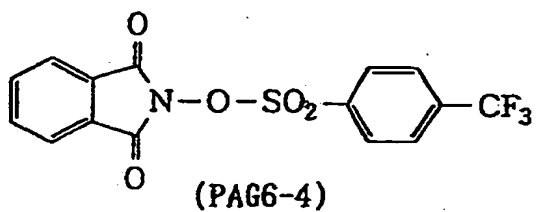
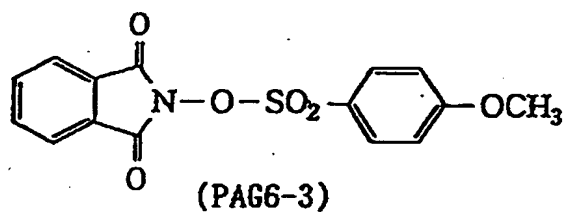
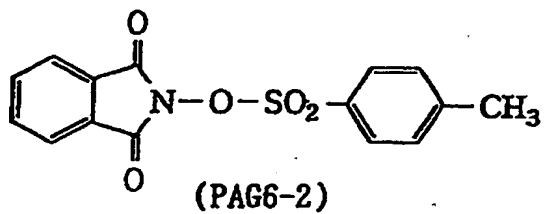
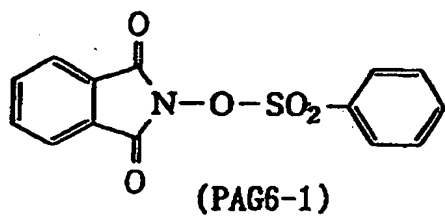
【0093】

【化 38】



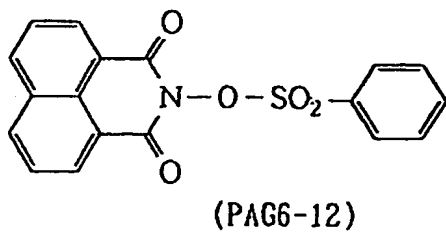
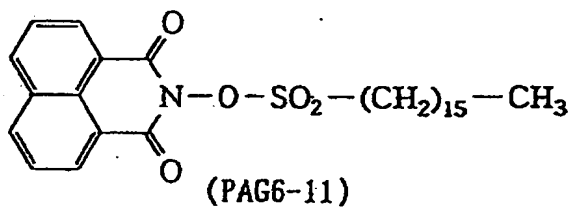
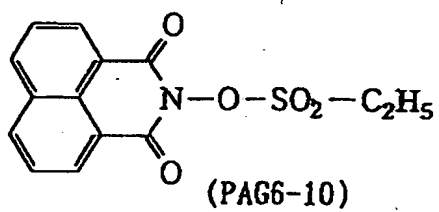
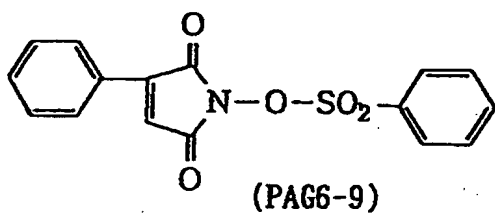
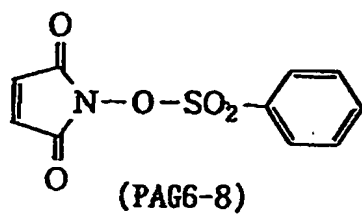
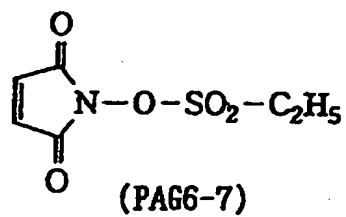
【0094】

【化 39】



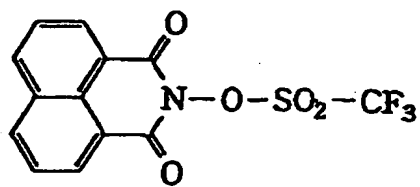
【0095】

【化40】

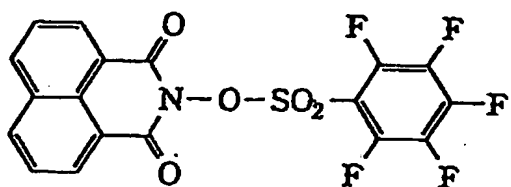


【0096】

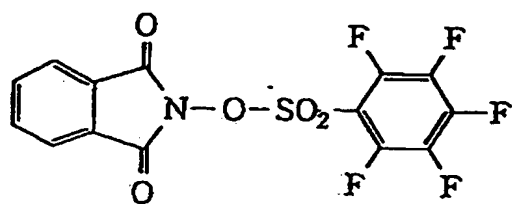
【化 4 1】



(PAG6-13)



(PAG6-14)

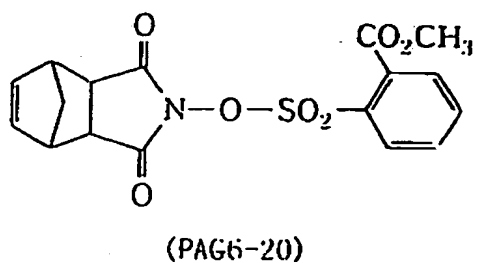
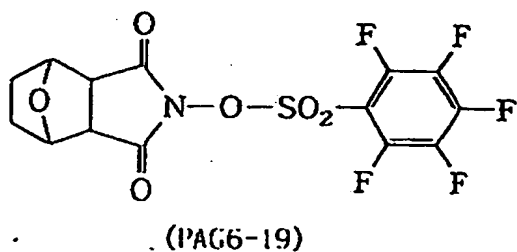
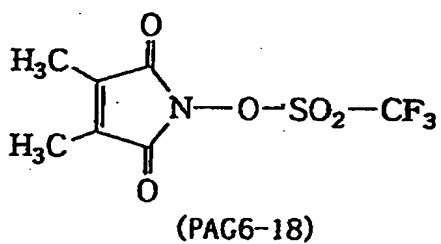
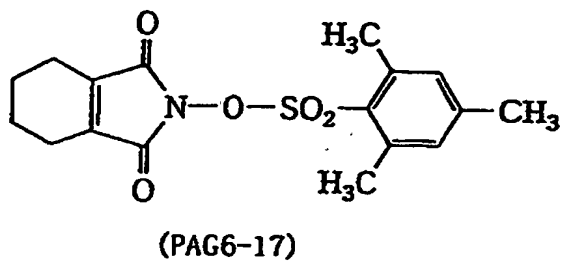
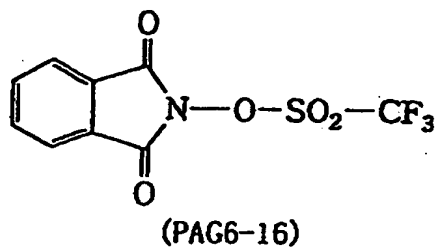


(PAG6-15)

【0097】



【化 4 2】

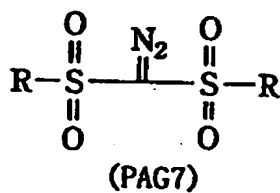


【0098】

(4) 下記一般式 (PAG 7) で表されるジアソジスルホン誘導体。

【0099】

【化 4 3】



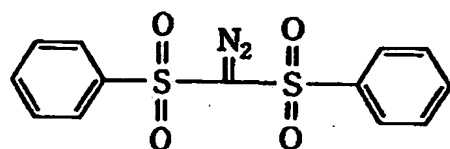
【0 1 0 0】

ここでRは、直鎖、分岐又は環状アルキル基、あるいは置換してもよいアール基を表す。

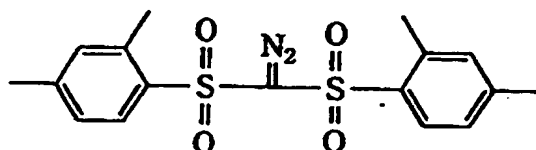
具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0 1 0 1】

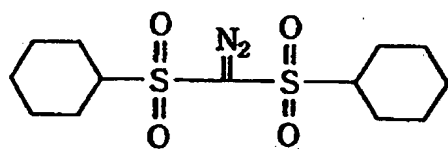
【化 4 4】



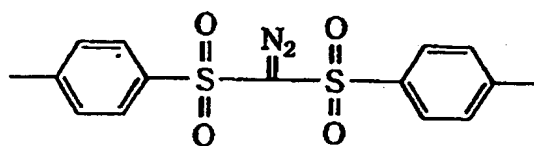
(PAG7-1)



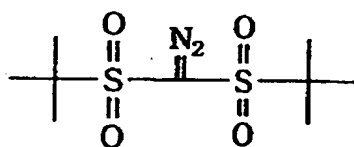
(PAG7-2)



(PAG7-3)



(PAG7-4)



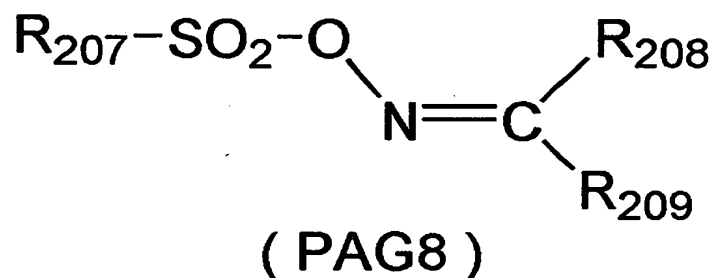
(PAG7-5)

【0102】

(5) 下記一般式 (PAG 8) で表されるオキシムスルホネート誘導体。

【0103】

【化 4 5】



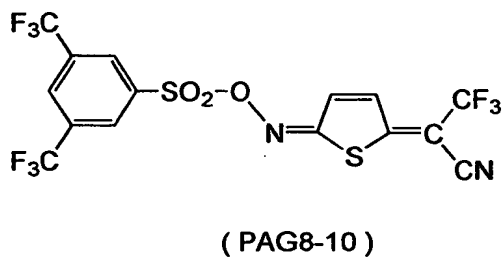
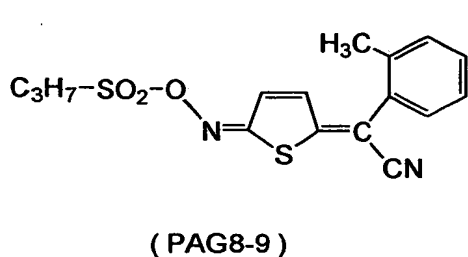
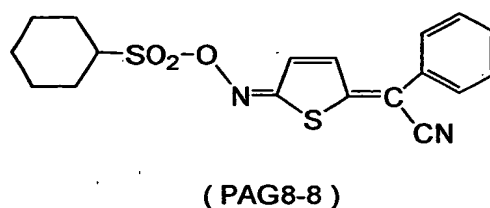
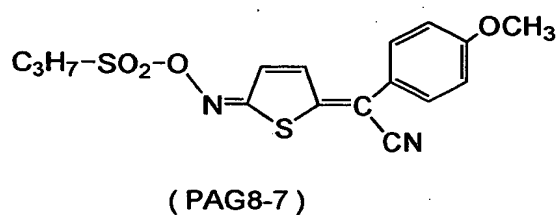
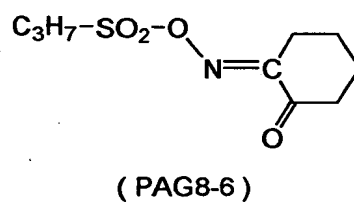
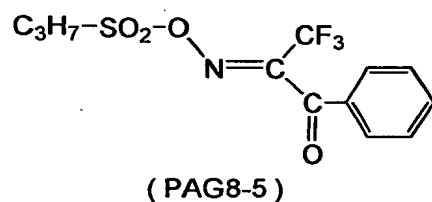
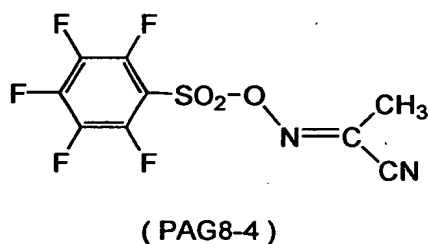
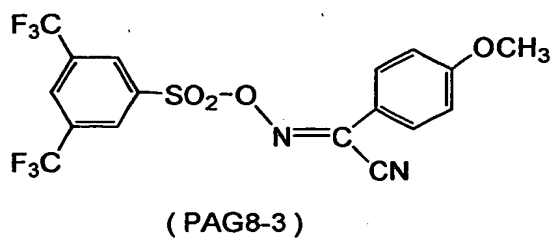
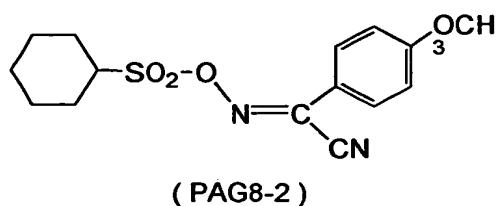
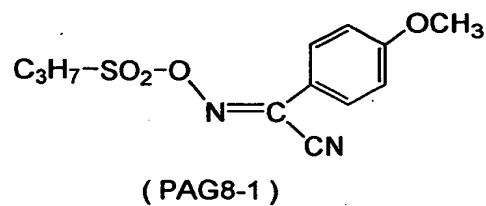
【0104】

式中、R<sub>207</sub>は置換もしくは未置換のアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基を示す。R<sub>208</sub>、R<sub>209</sub>は置換もしくは未置換のアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、シアノ基、もしくはアシル基を示す。R<sub>208</sub>、R<sub>209</sub>が結合し、炭素環、もしくは酸素原子、窒素原子、又は硫黄原子を有するヘテロ環を形成しても良い。

具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これに限定されるものではない。

【0 1 0 5】

## 【化 46】



## 【0106】

本発明（B）の活性光線又は放射線の照射により、酸を発生する化合物の添加量は、本発明の組成物の全固形分を基準として、0.1～20重量%であり、好ましくは0.5から10重量%、更に好ましくは1～7重量%である。またこれらの化合物は単独で使用しても良く、複数を混合して使用しても良い。

【 0 1 0 7 】

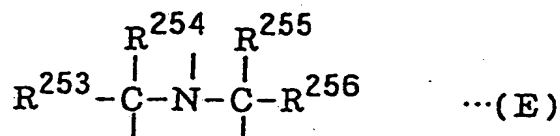
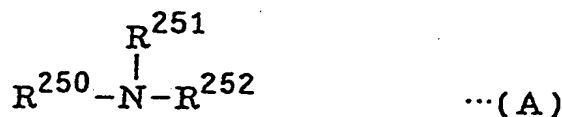
## 〔 3 〕 本 発 明 ( C ) の 酸 拡 散 抑 制 剤

本発明の組成物には、活性光線又は放射線の照射後、加熱処理までの経時による性能変動（パターンのT-t o p形状形成、感度変動、パターン線幅変動等）や塗布後の経時による性能変動、更には活性光線又は放射線の照射後、加熱処理時の酸の過剰な拡散（解像度の劣化）を防止する目的で、酸拡散抑制剤を添加することが好ましい。酸拡散抑制剤としては、有機塩基性化合物であり、例えば塩基性窒素を含有する有機塩基化合物であり、共役酸のp K a 値で4以上の化合物が好ましく使用される。

具体的には下記式（A）～（E）の構造を挙げることができる。

【 0 1 0 8 】

〔 化 4 7 〕



【 0 1 0 9 】

ここで、 $\text{R}^{250}$ 、 $\text{R}^{251}$  及び  $\text{R}^{252}$  は、同一でも異なってもよく、水素原子、炭素数1～6個のアルキル基、炭素数1～6個のアミノアルキル基、炭素数1～6個のヒドロキシアルキル基又は炭素数6～20個の置換もしくは非置換のアリ

ール基を表し、ここで、 $R^{251}$ と $R^{252}$ は、互いに結合して環を形成してもよい。

$R^{253}$ 、 $R^{254}$ 、 $R^{255}$  及び  $R^{256}$  は、同一でも異なってもよく、炭素数1～6個のアルキル基を表す。

更に好ましい化合物は、一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物であり、特に好ましくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素原子を含む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキルアミノ基を有する化合物である。

#### 【0110】

好ましい具体例としては、置換もしくは未置換のグアニジン、置換もしくは未置換のアミノピリジン、置換もしくは未置換のアミノアルキルピリジン、置換もしくは未置換のアミノピロリジン、置換もしくは未置換のインダゾール、イミダゾール、置換もしくは未置換のピラゾール、置換もしくは未置換のピラジン、置換もしくは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換のプリン、置換もしくは未置換のイミダゾリン、置換もしくは未置換のピラゾリン、置換もしくは未置換のピペラジン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置換もしくは未置換のアミノアルキルモルフォリン等が挙げられる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリールアミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ基、水酸基、シアノ基である。

#### 【0111】

特に好ましい化合物として、グアニジン、1, 1-ジメチルグアニジン、1, 1, 3, 3-テトラメチルグアニジン、イミダゾール、2-メチルイミダゾール、4-メチルイミダゾール、N-メチルイミダゾール、2-フェニルイミダゾール、4, 5-ジフェニルイミダゾール、2, 4, 5-トリフェニルイミダゾール、2-アミノピリジン、3-アミノピリジン、4-アミノピリジン、2-ジメチルアミノピリジン、4-ジメチルアミノピリジン、2-ジエチルアミノピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、2-アミノ-3-メチルピリジン、2-アミノ-4-メチルピリジン、2-アミノ-5-メチルピリジン、2-アミノ-6-メチルピリジン、3-アミノエチルピリジン、4-アミノエチルピリジン、

## 【0112】

3-アミノピロリジン、ピペラジン、N-(2-アミノエチル)ピペラジン、N-(2-アミノエチル)ピペリジン、4-アミノ-2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン、4-ピペリジノピペリジン、2-イミノピペリジン、1-(2-アミノエチル)ピロリジン、ピラゾール、3-アミノ-5-メチルピラゾール、5-アミノ-3-メチル-1-p-トリルピラゾール、ピラジン、2-(アミノメチル)-5-メチルピラジン、ピリミジン、2, 4-ジアミノピリミジン、4, 6-ジヒドロキシピリミジン、2-ピラゾリン、3-ピラゾリン、N-アミノモルフォリン、N-(2-アミノエチル)モルフォリンなどが挙げられるがこれに限定されるものではない。

これらの含窒素塩基性化合物は、単独であるいは2種以上一緒に用いられる。

## 【0113】

酸発生剤と有機塩基性化合物の組成物中の使用割合は、(酸発生剤)/(有機塩基性化合物)(モル比)=2.5~300であることが好ましい。該モル比が2.5未満では低感度となり、解像力が低下する場合があります、また、300を越えると露光後加熱処理までの経時でレジストパターンの太りが大きくなり、解像力も低下する場合があります。(酸発生剤)/(有機塩基性化合物)(モル比)は、好ましくは5.0~200、更に好ましくは7.0~150である。

## 【0114】

[4] 本発明に用いることができるフッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤

本発明のポジ型レジスト組成物には、フッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤を含有することができる。すなわち、本発明のポジ型レジスト組成物には、フッ素系界面活性剤、シリコン系界面活性剤及びフッ素原子と珪素原子の両方を含有する界面活性剤のいずれか、あるいは2種以上を含有することができる。これらフッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤の添加は、現像欠陥の抑制及び塗布性の向上に効果を有する。

## 【0115】

これらの界面活性剤として、例えば特開昭62-36663号、特開昭61-226746号、特開昭61-226745号、特開昭62-170950号、特開昭63-34540号、特開平7-230165号



、特開平8-62834号、特開平9-54432号、特開平9-5988号、米国特許5405720号、米国特許5360692号、米国特許5529881号、米国特許5296330号、米国特許5436098号、米国特許5576143号、米国特許5296143号、米国特許5294511号、及び、米国特許5824451号記載の界面活性剤を挙げることができ、下記市販の界面活性剤をそのまま用いることもできる。

このような市販の界面活性剤として、例えばエフトップEF301、EF303、EF352(新秋田化成(株)製)、フロラードFC430、431(住友スリーエム(株)製)、メガファックF171、F173、F176、F189、R08(大日本インキ(株)製)、アサヒガードAG710、サーフロンS-382、SC101、102、103、104、105、106(旭硝子(株)製)、トロイゾルS-366(トロイケミカル社製)等のフッ素系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤を挙げることができる。またポリシロキサンポリマーKP-341(信越化学工業(株)製)もシリコン系界面活性剤として用いることができる。

#### 【0116】

界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の固形分を基準として、通常0.001重量%~2重量%、好ましくは0.01重量%~1重量%である。これらの界面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いくつかの組み合わせで添加することもできる。

#### 【0117】

[5] 本発明の組成物に使用されるその他の成分

##### (2) 溶剤類

本発明の組成物は、上記各成分を溶解する溶媒に溶かして支持体上に塗布する。ここで使用する溶媒としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、シクロペンタノン、2-ヘプタノン、 $\gamma$ -ブチロラクトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2-メトキシエチルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピルビン酸

プロピル、N，N－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、N－メチルピロリドン、テトラヒドロフラン等が好ましく、これらの溶媒を単独あるいは混合して使用する。

## 【0118】

精密集積回路素子の製造などにおいてレジスト膜上へのパターン形成工程は、基板（例：シリコン／二酸化シリコン皮覆、ガラス基板、ITO基板等の透明基板等）上に、本発明のポジ型レジスト組成物を塗布し、次に活性光線又は放射線描画装置を用いて照射を行い、加熱、現像、リンス、乾燥することにより良好なレジストパターンを形成することができる。

## 【0119】

本発明のポジ型レジスト組成物の現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、n－プロピルアミン等の第一アミン類、ジエチルアミン、ジ－n－ブチルアミン等の第二アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、コリン等の第四級アンモニウム塩、ピロール、ピペリジン等の環状アミン類、等のアルカリ類の水溶液を使用することができる。更に、上記アルカリ類の水溶液にイソプロピルアルコール等のアルコール類、ノニオン系等の界面活性剤を適当量添加して使用することもできる。

これらの現像液の中で好ましくは第四アンモニウム塩、更に好ましくは、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、コリンである。

## 【0120】

## 【実施例】

以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明の内容がこれにより限定されるものではない。

## 【0121】

## 〔合成例1〕

4-〔ビス(トリフルオロメチル)-ヒドロキシメチル〕スチレン 13.5 g (0.05 モル)、メタクリロニトリル 3.4 g (0.05 モル) を 1-メトキシ-2-プロパノール 60 ml に溶解し、重合開始剤として 2,2'-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル) (和光純薬工業(株)製; 商品名 V-65) 0.25 g を加えた。この溶液を窒素気流下、70℃ に加熱した 1-メトキシ-2-プロパノール 10 ml に、攪拌しながら 2 時間かけて滴下した。滴下後更に 4 時間攪拌を続けた。その後、反応液をメタノール/イオン交換水 (1/1) 1 L 中に激しく攪拌しながら投入。析出した樹脂をイオン交換水にて水洗し、濾別、真空下乾燥することにより、白色の樹脂 14.8 g を得た。NMR 測定により、この樹脂が構造例 (I-1) / (III-2) = 52/48 の樹脂であり、GPC 測定により、重量平均分子量 (ポリスチレン標準) が 8,900 であることを確認した。この樹脂を THF 100 ml に溶解し、エチルビニルエーテル 2.9 g (0.04 モル) を加え、p-トルエンスルホン酸を触媒量添加して、室温にて 8 時間攪拌した。反応液にトリエチルアミンを p-トルエンスルホン酸触媒の 2 倍量加えて反応を停止させ、イオン交換水 3 L 中に激しく攪拌しながら投入した。析出した樹脂を濾別、乾燥して本発明の樹脂 (1) 15.3 g を得た。GPC 測定により、樹脂 (1) の分子量は重量平均 (Mw) で 9,100 であった。また H-NMR、C-NMR、IR 測定により、樹脂 (1) の組成を調べたところ、モル比で構造例 (I-1) / (I-4) / (III-2) = 10/42/48 であった。

以下同様にして、表 1 に示す本発明の樹脂を合成した。

【0122】

【表1】

表1 本発明の樹脂(A)の合成

樹脂(A)	組成(樹脂中の構造単位とモル比)	分子量
(2)	$(I-1)/(I-7)/(III-2)$ $=9/43/48$	9,900
(3)	$(I-3)/(III-2)$ $=53/47$	10,700
(4)	$(I-10)/(III-2)$ $=54/46$	11,200
(5)	$(I-1)/(I-11)$ $=39/61$	13,400
(6)	$(I-1)/(I-12)/(III-6)$ $=10/48/42$	8,700
(7)	$(I-14)/(III-2)$ $=51/49$	9,400
(8)	$(I-20)/(III-2)/(V-5)$ $=51/32/17$	11,700
(9)	$(I-1)/(I-12)$ $=34/64$	10,300
(10)	$(I-1)/(I-21)/(B-31)$ $=32/51/17$	8,500
(11)	$(I-1)/(I-27)/(III-2)$ $=11/46/43$	9,700
(12)	$(I-1)/(I-15)/(B-7)$ $=18/51/31$	11,900

【0123】

## 【実施例1(透過率の測定)】

上記表1に示した樹脂(1)～(6)については、各樹脂1.36gにトリフェニルスルホニウムのノナフレート塩(PAG4-3)0.02g、イミドスルホネート化合物(PAG6-19)0.02gを加え、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート8.5gに溶解し、これにジシクロヘキシルメチルアミン0.005gとフッ素系界面活性剤としてメガファックR08(大日本インキ(株)製)0.01gを添加して、本発明のレジスト組成物を調整した。樹脂(7)～(12)については、各樹脂1.36gにトリフェニルスルホニウムのノナフレート塩(PAG4-3)0.04gを加え、プロピレングリコールモ

ノメチルエーテルアセテート 8.5 g に溶解し、これにジシクロヘキシルメチルアミン 0.005 g とフッ素系界面活性剤としてメガファック R08（大日本インキ（株）製）0.01 g を添加して、本発明のレジスト組成物を調整した。

## 【0124】

各試料溶液を 0.1  $\mu$ m のテフロンフィルターで濾過した後、スピncerコーターによりフッ化カルシウムディスク上に塗布し、120℃、5 分間で加熱乾燥して、膜厚 0.1  $\mu$ m のレジスト膜を得た。Action CAMS-507 スペクトロメーターにて塗膜の吸収を測定し、157 nm における透過率を算出した。結果を表 2 に示す。

## 【0125】

【表 2】

表 2

本発明の樹脂	157 nm における透過率 (%)
(1)	46
(2)	47
(3)	48
(4)	53
(5)	55
(6)	52
(7)	56
(8)	53
(9)	57
(10)	51
(11)	45
(12)	53
比較例 1 (アセタール系 KrF 用 市販レジスト)	18

## 【0126】

表 2 の結果から、本発明の組成物を用いた塗膜の透過率測定値は、ほぼ 50 % を超え、157 nm に十分な透過性を有することが判る。

【 0 1 2 7 】

〔実施例 2（塗布性、現像欠陥の評価）〕

実施例 1 における界面活性剤を下記 W-1～W-4 に変え、本発明のレジスト組成物を調整した。使用した界面活性剤は表 5 に示す。

【 0 1 2 8 】

界面活性剤としては、

W1：メガファック F176（大日本インキ化学工業（株）製）（フッ素系）

W2：メガファック R08（大日本インキ化学工業（株）製）

（フッ素及びシリコン系）

W3：ポリシロキサンポリマー KP-341（信越化学工業（株）製）

W4：ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル

を表す。

【 0 1 2 9 】

各試料溶液を 0.1  $\mu\text{m}$  のテフロンフィルターで濾過した後、スピンコーターによりヘキサメチルジシラザン処理を施したシリコンウェハー上に塗布し、110℃、90 秒間真空密着型のホットプレート上で加熱乾燥して、膜厚 0.3  $\mu\text{m}$  のレジスト膜を得た。得られたレジスト膜に対し、Canon 社 KrF エキシマステッパー（FPA-3000EX5）を用い画像露光を行ない、110℃、90 秒にて後加熱した後、0.262N の TMAH 水溶液で現像することにより 0.5  $\mu\text{m}$  の L/S のパターンを形成させた。

【 0 1 3 0 】

現像欠陥及び塗布性は、以下のようにして評価した。

〔現像欠陥数〕： 上記のようにして得られたレジストパターンについて、ケーエルエー・テンコール（株）製 KLA-2112 機により現像欠陥数を測定し、得られた 1 次データ値を現像欠陥数とした。

【 0 1 3 1 】

〔塗布性（面内均一性）〕： 各レジスト溶液を 8 インチシリコンウェハ上に塗布し、上記のようなレジスト層の塗設同様の処理を行い、面内均一性測定用のレジスト塗布膜を得た。これを大日本スクリーン株式会社製 Lambda A にて、

塗布膜厚をウエハ直径方向に沿って十字になるように均等に 3 6 箇所測定した。

各測定値の標準偏差をとり、その 3 倍が 5 0 に満たないものを○、5 0 以上のものを×として評価した。

性能評価結果を表 3 に示した。

【0 1 3 2】

【表 3】

表 3.

本発明の樹脂 (A)	使用した界面活性剤	現像欠陥	塗布性
(1)	W-1	1 6	○
(2)	W-2	2 0	○
(3)	W-3	2 3	○
(4)	W-2	2 1	○
(5)	W-2	1 9	○
(6)	W-3	1 8	○
(7)	W-1	2 2	○
(8)	W-2	2 3	○
(9)	W-3	1 9	○
(10)	W-2	2 4	○
(11)	W-1	2 3	○
(12)	W-3	2 5	○
(1)	なし	2 0 0 0	×
(1)	W-4	6 5 0	×

【0 1 3 3】

表 3 の結果より、フッ素及び／又はシリコン系界面活性剤を加えた本発明の組成物は、同成分のない比較例に比べ、塗布性が大きく優れ、現像欠陥も非常に少なくなることが判る。

【0 1 3 4】

〔実施例 3 (画像形成性評価)〕

本発明の樹脂を使用し、実施例 1 と同様にしてレジスト液を調整した。各試料溶液を 0. 1  $\mu$ m のテフロンフィルターで濾過した後、スピナーによりヘキサメチルジシラザン処理を施したシリコンウェハ上に塗布し、1 1 0℃、9 0 秒間真空密着型のホットプレート上で加熱乾燥して、膜厚 0. 1  $\mu$ m のレジスト膜を得た。得られたレジスト膜に対し、1 5 7 nm のレーザー露光・溶解挙

動解析装置 V U V E S - 4 5 0 0 (リソテック・ジャパン製) を用い、1 5 7 n m 露光による露光部・未露光部の溶解コントラストを測定した。

結果を表 4 に示す。

【 0 1 3 5 】

【表 4】

表 4

本発明の樹脂	溶解コントラスト ( $\tan \theta$ )
(1)	5. 5
(2)	5. 7
(3)	5. 8
(4)	6. 4
(5)	6. 3
(6)	6. 2
(7)	6. 4
(8)	6. 3
(9)	6. 4
(10)	6. 6
(11)	5. 7
(12)	6. 7
比較例 4 (アセタール系 Kr F 用 市販レジスト)	5. 3 *1)

\* 1) Kr F エキシマレーザー (2 4 8 nm) 露光時の値

【 0 1 3 6 】

表 4 の結果より、本発明の組成物は、比較例の Kr F エキシマ用に実用されているレジスト同等の溶解コントラストを有する、即ち画像形成性を有することが判る。

【 0 1 3 7 】

【発明の効果】

本発明のポジ型レジスト組成物により、1 5 7 n m の短波長においても十分な透過性及び画像形成性を有し、且つフッ素樹脂に基づく塗布性、現像欠陥の問題



が改良されたポジ型レジスト組成物を提供できる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 160nm以下、特にF<sub>2</sub>エキシマレーザー光（157nm）の露光光源の使用に好適なポジ型レジスト組成物を提供することであり、具体的には157nmの光源使用時に十分な透過性を示し、且つ塗布性、現像欠陥を満足するポジ型レジスト組成物を提供すること。

【解決手段】 （A）特定の構造の繰り返し単位を少なくとも一つ有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解度を増大する樹脂、及び（B）活性光線又は放射線の照射により、酸を発生する化合物を含有するポジ型レジスト組成物。

【選択図】 なし

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005201]

1. 変更年月日 1990年 8月14日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 神奈川県南足柄市中沼210番地  
氏 名 富士写真フイルム株式会社